

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
25. Oktober 2001 (25.10.2001)

PCT

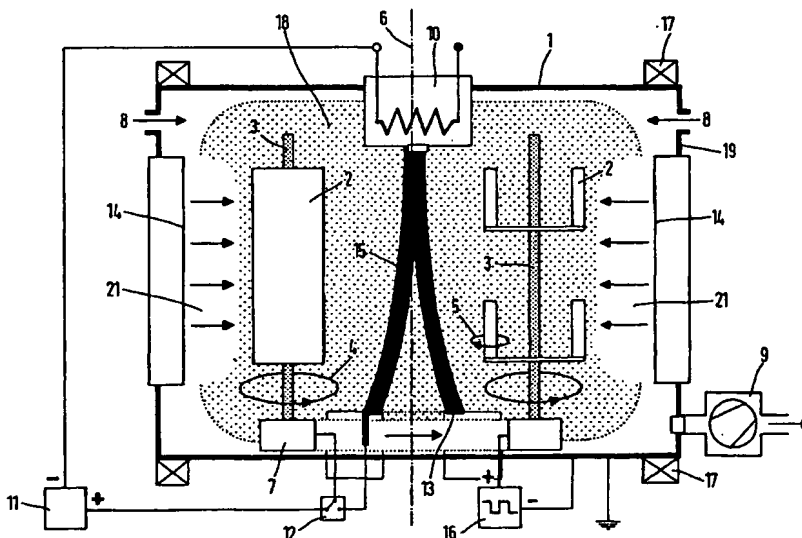
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 01/79585 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C23C 16/26, 16/02, H01J 37/32, C23C 14/35
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/13299
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
27. Dezember 2000 (27.12.2000)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
100 18 143.0 12. April 2000 (12.04.2000) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): UNAXIS BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT  
[LI/LI]; FL-9496 Balzers (LI).
- (72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MASSLER, Orlow  
[AT/AT]; Tafernstr. 20, A-6800 Feldkirch (AT). PE-  
DRAZZINI, Mauro [LI/LI]; Kapf 378, FL-9492 Eschen  
(LI). WOHLRAB, Christian [AT/AT]; Weinberggasse  
31a, A-6800 Feldkirch (AT). EBERLE, Hubert [LI/LI];  
Kreuzstr. 12, FL-9496 Balzers (LI). GRISCHKE, Martin  
[LI/LI]; Im Loch 12, FL-9494 Schaan (LI). MICHLER,  
Thorsten [DE/DE]; Essenheimer Strasse 119, 55128  
Mainz (DE).
- (74) Anwälte: HERRMANN-TRENTEPOHL, W. usw.;  
Forstenrieder Allee 59, 81476 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU,  
CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,  
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DLC LAYER SYSTEM AND METHOD FOR PRODUCING SAID LAYER SYSTEM

(54) Bezeichnung: DLC-SCHICHTSYSTEM SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DERARTIGEN SCHICHT-  
SYSTEMS



(57) Abstract: The invention relates to a method and device for producing a layer system for protection against wear and corrosion, and to improve sliding qualities or the like. Said layer system comprises an adhesive layer which is placed on a substrate, a transition layer which is placed on the adhesive layer and an outer layer which is made of diamond-like carbon. The adhesive layer comprises at least one element from the group consisting of the 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> subgroup and silicon. The transition layer consists of diamond-like carbon and at least one element of the above-mentioned group, and the outer layer substantially consists of diamond-like carbon. The layer system has a hardness of at least 15 GPa, preferably at least 20 GPa, and an adhesive strength of at least 3 HF according to VDI 3824 sheet 4.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 01/79585 A1



LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,  
MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL,  
TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

- (84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), curasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

---

(57) **Zusammenfassung:** Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung beschrieben, mit der es möglich ist, ein Schichtsystem für den Verschleisschutz, Korrosionsschutz und zur Verbesserung der Gleiteigenschaften oder dergleichen zu erzeugen, welches eine Haftschrift zur Anordnung auf einem Substrat, eine Übergangsschicht zur Anordnung auf der Haftschrift und eine Deckschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff aufweist, wobei die Haftschrift mindestens ein Element aus der Gruppe umfasst, die die Elemente 4., 5. und 6. Nebengruppe und Silizium beinhalten, wobei die Übergangsschicht Kohlenstoff und mindestens ein Element aus der vorgenannten Gruppe umfasst und die Deckschicht aus im wesentlichen diamantähnlichem Kohlenstoff besteht, wobei das Schichtsystem eine Härte von wenigstens 15 GPa, vorzugsweise mindestens 20 GPa und eine Haftfestigkeit von wenigstens 3 HF nach VDI 3824 Blatt 4 aufweist.

## **DLC-Schichtsystem mit verbesserten Gleiteigenschaften sowie Verfahren zur Herstellung eines derartigen Schichtsystems**

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schichtsystem nach Patentanspruch 1, ein Verfahren nach Patentanspruch 21 sowie eine Vorrichtung nach Patentanspruch 40. Bevorzugte Ausführungen der Erfindung werden in den Unteransprüchen 2 bis 20, 22 bis 39 und 41 sowie in der Beschreibung, Beispielen und Zeichnungen offengelegt.

Trotz der herausragenden Eigenschaften von diamantähnlichem Kohlenstoffschichten (DLC-Schichten), wie hoher Härte und ausgezeichneter Gleiteigenschaften, und einer langjährigen weltweiten Forschungstätigkeit, konnten bis heute noch keine reinen DLC-Schichten hergestellt werden, die auch bei grösseren Schichtdicken ( $> 1\mu\text{m}$ ) eine für den industriellen Einsatz in typischen Verschleisschutzanwendungen ausreichende Schichthaftung zeigen und eine ausreichende Leitfähigkeit aufweisen, um auf die mit vielen produktionstechnischen Nachteilen behafteten Hochfrequenz (HF)-Verfahren zur Herstellung verzichten zu können.

Als typische Verschleisschutzanwendungen seien hier einerseits Anwendungen im Maschinenbaubereich, wie Schutz vor Gleitverschleiss, Pitting, Kaltverschweissung etc., insbesondere auf Bauteilen mit gegeneinander bewegten Flächen, wie beispielsweise Zahnrädern, Pumpen- und Tassenstößel, Kolbenringe, Injektorennadeln, komplette Lagersätze oder deren einzelne Bestandteile u.v.a. genannt, sowie andererseits Anwendungen im Bereich der Materialbearbeitung zum Schutz der eingesetzten Werkzeuge zur spanenden oder umformenden Bearbeitung sowie bei Spritzgussformen.

Neben der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten im Verschleisschutzbereich sei hier noch ausdrücklich der Korrosionsschutz als weiterer vielversprechender Anwendungsbereich von derartigen DLC-Schichten genannt.

Reine DLC-Schichten können heute auf Grund der hohen Eigenspannungen und der damit verbundenen problematischen Haftung, insbesondere bei hochbeanspruchten Flächen im Verschleisschutz nur mit geringen, für viele Anwendungen unzureichenden Schichtdicken abgeschieden werden oder müssen durch zusätzlichen Einbau von Fremdatomen, wie beispielsweise Silizium, verschiedenen Metallen und Fluor in ihren Eigenschaften verändert werden. Allerdings war die damit erreichte Verringerung der Schichteigenspannungen und Verbesserung der Haftung immer mit einem deutlichem Härteverlust verbunden, der sich gerade im Verschleisschutzbereich oftmals negativ auf die Lebensdauer des jeweils beschichteten Gegenstands auswirken kann.

Ein zusätzliches Aufbringen von Einlaufschichten, die beispielsweise graphitischen Kohlenstoff und/oder eine Mischung aus Metall bzw. Metallkarbid und Kohlenstoff enthalten, konnte daher nicht in Betracht gezogen werden, da einerseits durch die zum Erreichen des Einlauffeffekts notwendige Mindestschichtdicke weitere schädliche Schichteigenspannungen aufgebaut wurden und andererseits die Haftung auf reinen Kohlenstoffschichten prob-

lematisch war. Erst solche Schichten können aber durch die Kombination der sehr harten Kohlenstoffschicht, bzw. Diamantschicht mit der darauf abgeschiedenen Gleit- bzw. Einlaufschicht den zunehmenden Anforderungen für Bauteile, wie sie beispielsweise für einzelne Komponenten im modernen Motorenbau gefordert werden entsprechen.

Bei heute üblichen plasmagestützten Verfahren zur Herstellung von DLC-Schichten werden auf Grund des hohen elektrischen Widerstandes harter DLC-Schichten häufig, um störende Aufladungen während der Beschichtung zu vermeiden, Prozesse mit einem HF-Bias bzw. -Plasma (als HF = Hochfrequenz werden im folgenden alle Frequenzen > 10 MHz verstanden), insbesondere mit der Industriefrequenz 13,56 MHz, angewandt. Die bekannten Nachteile dieser Technik, sind schwer beherrschbare Störungen elektronisch empfindlicher Prozesssteuerungseinheiten (HF-Rückkopplungen, Senderwirkung, ...) ein erhöhter Aufwand um HF-Ueberschläge zu vermeiden, Antennenwirkung der zu beschichtenden Substrate und ein damit verbundener relativ grosser Mindestabstand zwischen dem Beschichtungsgut, der eine optimale Raum- und Flächennutzung in der Beschichtungskammer verhindert. So ist bei HF-Verfahren genauestens darauf zu achten, dass es, beispielsweise durch eine zu hohe Beladungsdichte, falsche Substrat / Halterungsabstände etc., nicht zu einer Überlappung von Dunkelräumen kommt, wodurch schädliche Nebenplasmen entstehen. Derartige Nebenplasmen bilden einerseits Energiesenken und belasten so zusätzlich die Plasmageneratoren, andererseits kommt es durch derartige lokale Plasmakonzentrationen häufig zu einer thermischen Überhitzung der Substrate und unerwünschter Graphitisierung der Schicht.

Auf Grund der bei HF-Prozessen berechneten exponentiellen Abhängigkeit der Substratspannung von der Substratoberfläche

$$US/UE=CE/CS=(AE/AS)^4$$

wobei U für die Spannung, C für die Kapazität, A für die Oberfläche und die Indizes S für Substrat bzw. E für die Gegenelektrode stehen, kommt es bei steigender Substratoberfläche AS zu einem starken Abfall der Substratspannung US begleitet von einem starken Anstieg der Verlustleistung. Daher kann abhängig von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Generatoren nur eine bestimmte Maximalfläche beschichtet werden. Anderenfalls kann entweder nicht genügend Leistung in das System eingebracht bzw. die Potentialdifferenz (Substratspannung) nicht ausreichend hoch eingestellt werden, um den für gut haftende dichte Schichten notwendigen Ionplatingeffekt zu erzielen.

Ferner ist auf der Anlagenseite bei HF-Prozessen üblicherweise zusätzlicher apparativer Aufwand notwendig, um Generator- und Plasmaimpedanzen durch elektrische Netzwerke, wie beispielsweise eine sogenannte Matchbox, während des Prozesses dynamisch aneinander anzupassen.

Im folgenden werden kurz verschiedene aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren bzw. Schichtsysteme angeführt.

3

Die EP 87 836 offenbart ein DLC-Schichtsystem mit einem 0,1 – 49,1%igen Anteil metallischer Komponenten, welches beispielsweise mittels kathodischem Sputtern abgeschieden wird.

Die DE 43 43 354 A1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines mehrlagigen Ti-haltigen Schichtsystems mit einer Hartstoffschicht aus Titannitriden Titankarbid und Titanboriden sowie einer reibmindernden C-haltigen Oberflächenschicht, wobei der Ti- und N-Anteil in Richtung der Oberfläche fortschreitend verringert wird.

Einen gepulsten Plasmastrahl verwendet das in der US 5 078 848 beschriebene Verfahren zur Herstellung von DLC-Schichten. Auf Grund der gerichteten Teilchenstrahlung aus einer Quelle mit geringem Austrittsquerschnitt eignen sich aber solche Verfahren nur bedingt zur gleichmässigen Beschichtung grösserer Flächen.

Verschiedene CVD-Verfahren bzw. mit solchen Verfahren hergestellte SiDLC/DLC Mischschichten werden in den folgenden Dokumenten beschrieben:

Die EP-A-651 069 beschreibt ein reibminderndes Verschleisschutzsystem aus 2 – 5000 alternierenden DLC und SiDLC-Schichten. Ein Verfahren zur Abscheidung von a-DLC-Schichten mit einer Si-Zwischenschicht und daran anschliessender a-SiC:H-Uebergangszone zur Verbesserung der Haftung wird in der EP-A-600 533 beschrieben. Auch in der EP-A-885 983 und der EP-A-856 592 werden verschiedene Verfahren zur Herstellung solcher Schichten beschrieben. In der EP-A-885 983 beispielsweise wird das Plasma durch ein DC-beheiztes Filament erzeugt und die Substrate mit negativer Gleichspannung oder MF zwischen 20 – 10.000 kHz beaufschlagt (als MF = Mittelfrequenz wird im folgenden der Frequenzbereich zwischen 1 und 10.000 kHz verstanden).

Die US 4 728 529 beschreibt eine Methode zur Abscheidung von DLC unter Anwendung eines HF-Plasmas, bei der die Schichtbildung in einem Druckbereich zwischen 103 und 1 mbar aus einem sauerstofffreien Kohlenwasserstoffplasma, dem bei Bedarf Edelgas oder Wasserstoff beigemischt wird, erfolgt.

Der in der DE-C-195 13 614 beschriebene Prozess verwendet eine bipolare Substratspannung mit einer kürzeren positiven Pulsdauer in einem Druckbereich zwischen 50-1000 Pa. Damit werden Schichten im Bereich von 10 nm bis 10 µm und einer Härte zwischen 15 – 40 GPa abgeschieden.

Ein CVD-Verfahren mit unabhängig vom Beschichtungsplasma erzeugter Substratspannung wird in der DE-A-198 26 259 beschrieben, wobei bevorzugt bipolare, jedoch auch andere periodische veränderte Substratspannungen angelegt werden. Dies bedarf jedoch einer rela-

tiv aufwendigen, da in zweifacher Ausführung vorzusehenden, elektrischen Versorgungseinheit zur Durchführung des Verfahrens.

Weiters sind Verfahren aus einer Kombination traditioneller Hartstoffschichten mit einer kohlenstoffreichen Deckschicht mit günstigen Gleiteigenschaften schon länger bekannt.

Beispielsweise offenbart US 5,707,748 eine Schichtkombinationen aus metallhaltigen Hartstoffschichten (TiN, TiAlVN, WC) und einer weniger harten Metallkarbidschicht mit zunehmendem Gehalt an graphitisch, d.h. in  $sp^2$  Hybridisierung, gebundenem Kohlenstoff. Durch die guten Gleiteigenschaften von Metall/- bzw. Metallkarbid/Kohlenstoffschichten (MeC/C) werden diese bevorzugt in Tribosystemen eingesetzt, wo neben dem Schutz des beschichteten Teils eine Verringerung der Reibungskräfte und/oder ein Schutz des Gegenkörpers bewirkt werden sollen. Besonders wirkungsvoll haben sich diesbezüglich MeC/C-Schichten mit einem hohen C-Anteil erwiesen, bei denen durch die weiche Deckschicht einerseits ein Einlaufeffekt, andererseits durch Übertrag von C-Partikeln ein Schmiereffekt für das ganze Tribosystem erreicht werden kann. Ähnliche Schichtkombinationen mit einer die Haftung verbessernden metallischen Zwischenschicht zwischen der Hartstoffschicht und der graphitischen Kohlenstoff enthaltenden Metall- bzw. MeC-Schicht werden in WO 99-55929 beschrieben.

Entsprechend ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung relativ dicke DLC-Schichtsysteme mit hoher Härte und ausgezeichneter Haftfestigkeit zur Verfügung zu stellen, die ausserdem noch eine genügend hohe Leitfähigkeit besitzen, um ohne HF-Bias abgeschieden werden zu können, so dass ein Verfahren und eine Vorrichtung verwendet werden können, die keinen grossen Aufwand erfordern und eine hohe Effektivität für den industriellen Einsatz aufweisen. Entsprechend ist es auch eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein entsprechendes Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird gelöst durch die Schicht mit den Merkmalen des Merkmalssatzes 1 sowie dem Verfahren nach Merkmalssatz 11 und der Vorrichtung gemäss Merkmalssatz 30. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Untermerkmalsätze.

Überraschenderweise hat sich weiters gezeigt, dass es möglich ist, auch relativ dicke DLC-Schichten mit einer zusätzlichen Schicht mit besonders günstigen Gleit- und falls erwünscht Einlaufeigenschaften zu versehen, ohne dass dadurch die Haftfestigkeit verschlechtert wird. Dadurch gelingt es erstmals die grosse Härte von reinen DLC-Schichten mit den günstigen Gleiteigenschaften von Metallkohlenstoffschichten zu kombinieren. Dies kann nicht nur durch Aufbringen von Gleitschichten auf erfinderische DLC-Schichtsysteme, sondern auch durch Anwendung eines der beschriebenen Verfahren zur Aufbringung einer Gleitschicht auf bekannte DLC-Schichten bzw. DLC-Schichtsysteme erfolgen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es somit insbesondere auch eine DLC- bzw. eine Diamantschicht mit einer ausgezeichneten Haftfestigkeit und einem hohen Verschleisswiderstand zur Verfügung zu stellen, die gegenüber herkömmlichen DLC- bzw. Diamantschichten verbesserte Gleiteigenschaften und falls erwünscht Einlaufeigenschaften aufweist. Eine solche DLC-Gleitschichtsystem kann für den Verschleisschutz, den Korrosionsschutz und zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Vorteil sein, insbesondere dann, wenn bis

jetzt schwer in einem Schichtsystem zu verwirklichende Eigenschaften gleichzeitig erwünscht sind.

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines erfindungsgemässen DLC-Gleitschichtsystems zu Verfügung zu stellen.

Dies wird erfindungsgemäss nach Absatz 1 der Beschreibung gelöst.

## SCHICHTSYSTEM

Ein erfindungsgemässes **DLC-Schichtsystem** wird durch Herstellen einer Schicht mit folgendem Schichtaufbau erreicht.

Direkt auf dem Substrat befindet sich eine Haftschrift mit mindestens einem Element aus der Gruppe der Elemente der IV, V und VI Nebengruppe sowie Si. Bevorzugt wird eine Haftschrift aus den Elementen Cr oder Ti verwendet, die sich für diesen Zweck als besonders geeignet erwiesen haben.

Daran schliesst sich eine Uebergangsschicht an, die vorzugsweise als Gradientenschicht ausgebildet ist, in deren Verlauf senkrecht zur Substratoberfläche der Metallgehalt ab – und der C-Gehalt zunimmt.

Die Uebergangsschicht umfasst im wesentlichen Kohlenstoff und mindestens ein Element aus der Gruppe der Elemente, die die Haftschrift bilden. Zusätzlich kann bei einer bevorzugten Ausführungsform Wasserstoff enthalten sein. Darüber hinaus beinhalten sowohl die Uebergangsschicht als auch die Haftschrift unvermeidbare Verunreinigungen, wie sie beispielsweise durch in die Schicht eingebaute Atome aus der umgebenden Atmosphäre gegeben sind, beispielsweise die bei der Herstellung verwendeten Edelgase, wie Argon oder Xenon.

Bei der Ausbildung der Uebergangsschicht in Form einer Gradientenschicht kann der Zuwachs des Kohlenstoffs in Richtung der Deckschicht durch Zunahme gegebenenfalls unterschiedlicher karbidischer Phasen, durch Zunahme des freien Kohlenstoffs, bzw. durch eine Mischung derartiger Phasen mit der metallischen Phase der Uebergangsschicht erfolgen. Die Dicke der Gradienten- bzw. Uebergangsschicht kann dabei, wie dem Fachmann bekannt, durch Einstellung geeigneter Prozessrampen eingestellt werden. Die Zunahme des C-Gehalt bzw. Abnahme der metallischen Phase kann kontinuierlich oder stufenweise erfolgen, ferner kann zumindest in einem Teil der Uebergangsschicht auch eine Abfolge metallreicher und C-reicher Einzelschichten zum weiteren Abbau von Schichtspannungen vorgesehen werden. Durch die erwähnten Ausbildungen der Gradientenschicht werden die Materialeigenschaften (beispielsweise E-Modul, Struktur etc.) der Haft- und der abschliessenden DLC-Schicht im wesentlichen kontinuierlich aneinander angepasst und damit der Gefahr der Rissbildung entlang einer sonst auftretenden Metall bzw. Si /DLC-Grenzfläche entgegengewirkt.

6

Den Abschluss des Schichtpakets bildet eine im wesentlichen ausschliesslich aus Kohlenstoff und vorzugsweise Wasserstoff bestehende Schicht, mit einer im Vergleich zur Haft- und Uebergangsschicht grösseren Schichtdicke. Zusätzlich zum Kohlenstoff und Wasserstoff können auch hier Edelgase, wie Argon oder Xenon vorkommen. Wesentlich ist hier jedoch, dass auf zusätzliche metallische Elemente oder Silizium vollständig verzichtet wird.

Die Härte des gesamten DLC-Schichtsystems ist auf einen Wert grösser 15 GPa, bevorzugt grösser/gleich 20 GPa eingestellt und eine Haftfestigkeit besser oder gleich HF 3, bevorzugt besser oder gleich HF 2, insbesondere gleich HF 1 nach VDI 3824 Blatt 4 wird erreicht. Die Härte wird hierbei über die Knoop Härtemessung mit 0,1 N Last, d.h. HK0,1 entsprechen. Der Oberflächenwiderstand der DLC-Schicht liegt zwischen  $\delta = 10\text{-}6\Omega$  und  $\delta = 5M\Omega$ , bevorzugt zwischen  $1\Omega$  und  $500\text{ k}\Omega$ , bei einem Elektrodenabstand von 20 mm. Gleichzeitig zeichnet sich die vorliegende DLC-Schicht durch die für DLC typische niedrige Reibkoeffizienten, bevorzugt  $\mu \leq 0.3$  im Stift / Scheibetest, aus.

Die Schichtdicken sind insgesamt  $> 1\text{ }\mu\text{m}$ , vorzugsweise  $> 2\text{ }\mu\text{m}$ , wobei die Haftsicht und die Uebergangsschicht vorzugsweise Schichtdicken von  $0.05\text{ }\mu\text{m}$  bis  $1,5\text{ }\mu\text{m}$ , insbesondere von  $0,1\text{ }\mu\text{m}$  bis  $0,8\text{ }\mu\text{m}$  aufweisen, während die Deckschicht vorzugsweise eine Dicke von  $0,5\text{ }\mu\text{m}$  bis  $20\text{ }\mu\text{m}$ , insbesondere  $1\text{ }\mu\text{m}$  bis  $10\text{ }\mu\text{m}$  hat.

Der H-Gehalt ist in der Deckschicht vorzugsweise 5 bis 30 Atom%, insbesondere 10 – 20 Atom%.

In REM-Aufnahmen zeigen erfindungsgemässe abgeschiedene DLC-Schichtsysteme Bruchfläche, die im Gegensatz zu herkömmlichen DLC-Schichten, keine glasig-amorphe sondern eine feinkörnige Struktur aufweisen, wobei die Korngrösse bevorzugt  $\leq 300\text{ nm}$ , insbesondere  $\leq 100\text{ nm}$  beträgt.

In tribologischen Tests unter hoher Belastung zeigt die Beschichtung eine vielfache Lebensdauer gegenüber anderen DLC-Schichten, wie beispielsweise Metallkohlenstoff-, insbesondere WC/C-Schichten. So konnte auf einer mit einer DLC-Schicht versehenen Einspritzdüse für Verbrennungsmotoren im Test nach 1000h nur ein geringfügiger Verschleiss festgestellt werden, wohingegen im selben Test eine mit WC/C beschichtete Düse bereits nach 10h auf Grund eines hohen Oberflächenverschleisses bis in den Grundwerkstoff ausfiel.

Die Schichtrauigkeit der erfindungsgemässen DLC-Schicht hat vorzugsweise einen Wert von  $R_a=0.01\text{-}0.04$ ; wobei  $R_z$  nach DIN gemessen  $< 0.8$  bevorzugt  $< 0.5$  ist.

Die Vorteile eines erfindungsgemässen DLC-Schichtsystems mit obigen Eigenschaften liegen in der erstmals gelungenen Kombination von grossen Schichtdicken mit ausgezeichneter Haftfestigkeit, die noch eine ausreichende Leitfähigkeit aufweisen, um eine verhältnismässig einfache Prozessführung in der industriellen Produktion zu ermöglichen.



Trotz der hohen Härte von  $> 15$  GPa, bevorzugt  $\geq 20$  GPa zeigt die Schicht auf Grund ihrer Struktur und der erfindungsgemässen Verfahrensschritte eine deutlich verbesserte Haftung. Herkömmliche Schichtsysteme benötigen hier eine Dotierung in der Funktionsschicht (DLC), um die Schichtspannung zu reduzieren, was aber auch die Härte reduziert.

Auch REM-Bruchbilder der erfindungsgemässen Schicht zeigen im Gegensatz zu bisher bekannten DLC-Schichten, die die typische Bruchform einer amorphen spröden Schicht mit teils muscheligen Ausbrüchen besitzen, eine feinkörnige gerade Bruchfläche. Schichten mit dem oben beschriebenen Eigenschaftsprofil eignen sich besonders für Anwendungen im Maschinenbau wie zum Beispiel zur Beschichtung von hochbelasteten Pumpen- bzw. Tassenstösseln und Ventiltrieben, Nocken bzw. Nockenwellen wie sie für Kfz-Verbrennungsmotoren und Getriebe verwendet werden, aber auch für den Schutz von hochbelasteten Zahnrädern, Plungern, Pumpenspindeln u.a. Bauteilen bei denen eine besonders harte und glatte Oberfläche mit guten Gleiteigenschaften benötigt wird.

Im Werkzeugbereich können dies Schichten auf Grund ihrer hohen Härte und sehr glatten Oberfläche vorteilhaft vor allem für Umform- (Pressen, Stanzen, Tiefziehen, ...) und Spritzgusswerkzeuge, jedoch auch, mit gewissen Einschränkungen bei der Bearbeitung von Eisenwerkstoffen, für Schneidwerkzeuge eingesetzt werden, insbesondere wenn für die Anwendung ein geringer Reibkoeffizient gepaart mit einer hohen Härte notwendig ist.

Die Wachstumsgeschwindigkeit der DLC-Schicht liegt bei etwa  $1-3 \mu\text{m/h}$ , die Schichtspannung für das ganze System bei  $1-4$  GPa und somit im üblichen Bereich von harten DLC-Schichten. Die Leitfähigkeit wird auf Grund der obiger Ausführungen etwa zwischen  $\delta = 10^{-6} \Omega$  und  $\delta = 5 \text{ M}\Omega$ , bevorzugt zwischen  $\delta = 10^{-3} \Omega$  und  $\delta = 500 \text{ k}\Omega$  eingestellt (gemessen wurde hierbei der Oberflächenwiderstand bei einem Abstand der Messelektroden von  $20 \text{ mm}$ ).

Die mit erfindungsgemäss abgeschiedenen DLC-Schichtsystemen erreichten Gleiteigenschaften sind zwar günstiger als die anderer beispielsweise nitridischer und/oder karbidischer Hartstoffschichten, erreichen aber weder die ausserordentlich kleinen Reibkoeffizienten die sich mit Metall/Kohlenstoffschichten verwirklichen lassen, noch sind sie als Einlaufschichten geeignet.

Sollen die Gleit- bzw. Einlaufeigenschaften der DLC-Schicht bzw. des DLC-Schichtsystems weiter verbessert werden, so empfiehlt es sich noch eine abschliessende weichere, einen relativ grossen Anteil an graphitischen Kohlenstoff enthaltende Gleitschicht aufzubringen. Letztere kann auch vorteilhaft auf nicht erfinderische DLC-Schichten und -Schichtsysteme sowie auf Diamantschichten, insbesondere auf nanokristalline Diamantschichten, aufgebracht werden.

Im Folgenden wird der Aufbau eines erfindungsgemässen **DLC-Gleitschichtsystems** beschrieben, das vorteilhafterweise, jedoch keinesfalls einschränkend, aus einem wie oben beschriebenen DLC-Schichtsystem mit einer darauf abgelegten Gleitschicht besteht. Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass es mit sehr unterschiedlich aufgebauten Gleitschichten möglich ist neben der Verbesserung der Gleit- und eventuell Einlaufeigenschaften,



trotz der erhöhten Schichtdicke die ausgezeichnete Haftfestigkeit des DLC-Schichtsystems für das DLC-Gleitschichtsystem zu erhalten.

Eine, insbesondere zur Anwendung auf oben beschriebene erfinderische DLC-Schichtsystem besonders geeignete, vorteilhafte Ausführungsform der reibmindernden Schicht besteht darin eine DLC-Struktur, ohne metallischem Zusatzelement, dafür aber mit zunehmendem Anteil an  $sp^2$ -Bindungen, bevorzugt in graphitischer Schichtstruktur aufzubringen, womit die Härte der Deckschicht herabgesetzt, sowie die Gleit- und gegebenenfalls Einlaufeigenschaften verbessert werden.

Eine andere vorteilhafte Ausführung der Gleitschicht kann durch Ausbildung einer zweiten, inversen Gradientenschicht erfolgen, bei der der Metallgehalt zur Oberfläche zu, der C-Gehalt aber abnimmt. Dabei wird der Metallgehalt solange erhöht, bis der Reibkoeffizient einen gewünschten niedrigen Wert erreicht. Bevorzugt wird dazu ein oder mehrere Metalle aus der IV, V, VI Nebengruppe, sowie Si verwendet. Besonders bevorzugt Cr, W, Ta, Nb und/oder Si. Der Metallanteil der Schichten sollte dabei zwischen 0.1 und 50 atom%, bevorzugt zwischen 1 und 20 atom% liegen.

Eine weitere bevorzugte Ausführung der reibmindernden Schicht kann durch Aufbringen einer metallischen bzw. karbidischen, insbesondere einer Cr- oder WC-Zwischenschicht, auf die im wesentlichen ausschliesslich aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehende Schicht, hergestellt werden, wobei anschliessend wiederum eine ähnlich der ersten Gradientenschicht ausgebildete Gradientendeckschicht mit abnehmendem Metall- und zunehmenden C-Gehalt folgt. Vorteilhafter- aber nicht zwingender Weise wird dabei dasselbe oder dieselben metallischen Elemente wie in der ersten Gradientenschicht verwendet um die Komplexität der Beschichtungsvorrichtung möglichst gering zu halten. Auch hier sollte der Metallanteil der Schichten dabei zwischen 0.1 und 50 atom%, bevorzugt zwischen 1 und 20 atom% liegen.

Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass gerade metallhaltige Gleitschichten auch auf herkömmlich abgeschiedenen DLC-Schichten eine deutliche Verbesserung der Performance bewirken können. Ein Grund für den damit erzielten geringen Einfluss auf die Gesamthaftung solcher Systeme könnte auf die gut einstellbaren, geringen zusätzlich eingebrachten Schichtspannungen zurückzuführen sein.

Für alle drei Möglichkeiten hat es sich als vorteilhaft erwiesen, einen abschliessenden Bereich mit unveränderter d.h. konstanter Schichtzusammensetzung vorzusehen, um die auf die jeweilige Anwendung optimierten Eigenschaften der Schicht (z.B. Reibbeiwert, Oberflächenspannung und Benetzbarkeit, ...) auch über einen gewissen Schichtverschleiss aufrecht zu erhalten und ein Einlaufen der Schicht zu ermöglichen.

Der Reibbeiwert kann je nach verwendetem Metall und verbleibendem Überschuss an graphitischem Kohlenstoff zwischen  $\mu = 0.01$  und  $\mu = 0.2$  eingestellt werden (bezieht sich auf Stift / Scheibetest unter Normalatmosphäre mit ca. 50% Luftfeuchte).

Die Härte der DLC-Schicht ist bevorzugt auf einen Wert grösser 15 GPa, bevorzugt grösser/gleich 20 GPa eingestellt, die Härte der darüberliegenden weicheeren Gleitschicht wird je nach Bedarf eingestellt.

Der integrale Wasserstoffgehalt des erfindungsgemässen Schichtsystems wird bevorzugt auf einen Gehalt zwischen 5-30 Atom% insbesondere zwischen 10-20 Atom% eingestellt.

9

Die Schichtrauigkeit kann auf einen Ra-Wert von unter 0.04 bevorzugt unter 0.01, bzw. einen  $Rz_{DIN}$ -Wert von kleiner 0.8 bevorzugt kleiner 0.5 eingestellt werden.

Die Vorteile solcher erfindungsgemässer DLC-Gleitschichtsystems liegen in der Kombination der grossen Härte der DLC-Schicht, gepaart mit einer gegenüber den bereits guten Laufverhalten der DLC-Schicht nochmals um bis zu einer Grössenordnung verbesserten Gleiteigenschaften. So kann beispielsweise der Reibkoeffizient damit unter  $\mu = 0.1$  gesenkt werden. Weiters gelingt es damit erstmals auch DLC-Schichten ein Einlaufverhalten durch anfänglichen Schichtabtrag und graphitische Gegenkörperschmierung zu verleihen, wodurch auch der Verschleiss eines unbeschichteten Gegenkörpers deutlich verringert werden kann.

Weiters kann durch Verwendung einer oben beschriebenen reinen DLC-Schicht eine niedrigere Rz- bzw. Ra-Zahl, d.h. eine geringere Rauigkeit der beschichteten Oberflächen, als mit herkömmlich verwendeten Hartstoffschichten, insbesondere mit dem Arc-Verfahren aufgebracht, eingestellt werden. Bei solchen bekannten Hartstoff / Gleitschichtkombinationen kann durch insbesondere harte Rauigkeitsspitzen häufig das Einlaufen des Tribosystems gestört, wenn nicht sogar verhindert und werden, wodurch es zur teilweisen oder gänzlichen Zerstörung der Oberfläche eines Gegenkörpers kommen kann, insbesondere wenn dieser nicht selbst durch eine Hartschicht geschützt ist. Dies ist besonders in Tribosystemen mit hohem Gleitanteil, wie zum Beispiel Kipp- und Gleithebel auf Tassenstössel, unterschiedliche Verzahnungen u.a. von Bedeutung.

Die Überlegenheit von DLC-Gleitschichtsystemen zeigte sich hier in verschiedenen Anwendungen sowohl gegenüber bekannten Hartstoff / Gleitschichtkombinationen als auch gegenüber reinen DLC-Schichtsystemen.

Auch im Werkzeugbereich können dies Schichten auf Grund ihrer hohen Härte und sehr glatten Oberfläche vorteilhaft vor allem für Umform- (Pressen, Stanzen, Tiefziehen, ...) und Spritzgusswerkzeuge, jedoch auch mit gewissen Einschränkungen bei der Bearbeitung von Eisenwerkstoffen für Schneidwerkzeuge eingesetzt werden, insbesondere wenn für die Anwendung ein besonders geringer Reibkoeffizient eventuell gepaart mit einem definiertem Einlaufeffekt gewünscht wird. Beispielsweise wurde mit erfindungsgemäss beschichteten Bohrern bereits nach einmaligem Einsatz (ein Bohrloch) ein Poliereffekt auf der Spanablauffläche beobachtet, was beispielsweise für Tieflochbohrungen von Vorteil ist. So kann bei derartigen erfindungsgemäss beschichteten Werkzeugen auf ein teures Nachpolieren der Spanablaufflächen verzichtet werden.

Erfindungsgemässe DLC-Gleitschichtsysteme können glatter als herkömmliche beispielsweise mit Lichtbogenverdampfern abgeschieden Hartstoff / Gleitschichtkombinationen (z.B. TiAlN/ WC/C) abgeschieden und einfacher, in einem durchlaufenden Prozess integriert werden als beispielsweise ebenfalls bekannte Ti-DLC // MoSx-Schichtkombinationen.

## VERFAHREN

Das erfindungsgemässe Verfahren zur Herstellung des DLC-Schichtsystems zeichnet sich weiterhin durch folgende Merkmale aus.

Die zu beschichtenden Teile werden in einer für PVD-Verfahren bekannten Weise gereinigt und auf einer Halterungsvorrichtung montiert. Im Gegensatz zu HF-Verfahren können dabei vorteilhafterweise Halterungsvorrichtungen mit – je nach Teilchengeometrie angepasst – 1,

2 oder auch 3 im wesentlichen parallelen Rotationsachsen verwendet werden, wodurch eine grössere Beladungsdichte erzielt werden kann. Die Halterungsvorrichtung mit den zu beschichtenden Teilen wird in die Prozesskammer einer Beschichtungsanlage gebracht und nach Abpumpen auf einen Startdruck von weniger als 10-4 mbar, vorzugsweise 10-5 mbar wird die Prozessfolge gestartet.

Der erste Teil des Prozesses, das Reinigen der Substratoberflächen, wird beispielsweise als Heizprozess durchgeführt, um die noch an der Oberfläche der Teile anhaftenden flüchtigen Substanzen zu entfernen. Dazu wird bevorzugt ein Edelgas -Plasma mittels einer Hochstrom/Niedervoltentladung zwischen einem oder mehreren, in einer an die Prozesskammer angrenzenden Ionisationskammer angeordneten, auf negatives Potential gelegten Filamenten und den auf positives Potential gelegten Halterungsvorrichtungen mit den Teilen gezündet. Dadurch wird ein intensiver Elektronenbeschuss und damit ein Erwärmen der Teile bewirkt. Als besonders günstig hat sich dabei die Verwendung eines Ar/H<sub>2</sub>-Gemisches erwiesen, da hierbei durch die reduzierende Wirkung des Wasserstoffs gleichzeitig ein Reinigungseffekt der Teileoberflächen erzielt wird. Die Hochstrom/Niedervoltbogenentladung kann dabei mit einem statischen oder vorteilhafterweise im wesentlichen örtlich variabel bewegten magnetischen Feld geführt werden. Statt der oben beschriebenen Ionisationskammer kann auch eine Hohlkathode oder eine andere bekannte Ionen- bzw. Elektronenquelle benutzt werden.

Alternativ können natürlich auch andere Heizverfahren wie z.B. Strahlungsheizen oder induktives Heizen verwendet werden.

Nach Erreichen eines, je nach Grundwerkstoff der Teile festzulegenden Temperaturniveaus, kann zusätzlich oder alternativ als Reinigungsprozess ein Aetzprozess gestartet werden, indem beispielsweise zwischen Ionisationskammer und einer Hilfsanode ein Niedervoltbogen gezündet wird, und die Ionen mittels einer negativen Biasspannung von 50-300 V auf die Teile gezogen werden. Die Ionen bombardieren dort die Oberfläche und entfernen restliche Verunreinigungen. Somit wird eine saubere Oberfläche erzielt. Die Prozessatmosphäre kann neben Edelgasen, wie z.B. Argon auch Wasserstoff enthalten.

Ferner kann der Aetzprozess auch durch Anlegen einer gepulsten Substratbiasspannung ohne oder mit Unterstützung durch einen, wie soeben beschriebenen Niedervoltbogen erfolgen, wobei vorzugsweise ein Mittelfrequenzbias im Bereich von 1 bis 10.000 kHz, insbesondere zwischen 20 und 250 kHz verwendet wird.

Um die Haftung des DLC-Schichtsystems auf dem Substrat zu gewährleisten, wird eine bevorzugt metallische, insbesondere aus Cr oder Ti bestehende Haftschicht mit einem bekannten PVD bzw. Plasma-CVD Verfahren, wie beispielsweise mittels Arcverdampfen, verschiedenen Ionplatingverfahren, bevorzugt jedoch durch kathodisches Sputtern mindestens eines Targets aufgedampft. Zur Unterstützung des Aufdampfens wird am Substrat eine negative Substratbiasspannung angelegt. Der Ionenbeschuss und die damit bewirkte Schichtverdichtung während des Sputterprozesses kann zusätzlich durch einen parallel be-

triebenen Niedervoltbogen und/oder ein zur Stabilisierung bzw. Intensivierung des Plasmas angelegtes Magnetfeld, und/oder durch das Anlegen einer DC-Biasspannung am Substrat oder durch das Anlegen eines Mittelfrequenzbias zwischen Substrat und Prozesskammer im Bereich von 1 bis 10.000, insbesondere zwischen 20 bis 250 kHz unterstützt werden.

Die Dicke der Haftschrift wird in bekannter Weise durch eine der jeweiligen Anlagengeometrie entsprechenden Wahl der Sputter- bzw. Aufdampfzeit und Leistung eingestellt.

Beispielsweise wird bei vorliegender, wie unten beschriebenen, Anlagengeometrie Cr für die Dauer von 6 Minuten von zwei vorteilhafterweise gegenüberliegenden Targets bei einem Druck zwischen  $10^{-4}$  bis  $10^{-3}$  mbar, einem Substratbias von  $U_{\text{bias}} = -75$  V und einer Leistung von ca. 8 kW in einer Ar-Atmosphäre gesputtert.

Nach Aufbringen der Haftschrift wird erfindungsgemäss durch Aufbringen einer Uebergangsschicht ein möglichst fließender Übergang zwischen Haftschrift und DLC-Schicht sichergestellt.

Das Aufbringen der Uebergangsschicht erfolgt so, dass neben dem plasmagestützten Aufdampfen der Haftschriftkomponenten zeitgleich Kohlenstoff aus der Gasphase abgeschieden wird. Dies erfolgt vorzugsweise über ein Plasma-CVD-Verfahren, bei dem ein kohlenstoffhaltiges Gas, vorzugsweise ein Kohlenwasserstoffgas, insbesondere Acetylen als Reaktionsgas verwendet wird.

Während des Aufbringens der Uebergangsschicht wird am Substrat eine insbesondere „gepulste“, mittelfrequente Substratbiasspannung angelegt und ein Magnetfeld überlagert.

Zur bevorzugten Ausbildung einer Gradientenschicht wird während des Aufbringens der Uebergangsschicht der Anteil der Kohlenstoffabscheidung mit zunehmender Dicke der Uebergangsschicht schrittweise oder kontinuierlich erhöht, bis letztendlich im wesentlichen nur noch eine Kohlenstoffabscheidung stattfindet.

In diesem Prozessstadium wird dann als Deckschicht die diamantähnliche Kohlenstoffschicht durch Plasma-CVD-Abscheidung von Kohlenstoff aus der Gasphase erzeugt, wobei als Reaktionsgas ein kohlenstoffhaltiges Gas, vorzugsweise ein Kohlenstoffwassergas, insbesondere Acetylen verwendet wird. Gleichzeitig wird am Substrat weiterhin eine Substratbiasspannung beibehalten und das überlagerte Magnetfeld aufrechterhalten.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann das Reaktionsgas zur Abscheidung von Kohlenstoff zur Bildung der Uebergangsschicht und der Deckschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff neben dem kohlenstoffhaltigen Gas zusätzlich Wasserstoff und Edelgas, vorzugsweise Argon oder Xenon, beinhalten. Der eingestellte Druck in der Prozesskammer beträgt dabei zwischen  $10^{-4}$  bis  $10^{-2}$  mbar.

Während des Abscheidens der Deckschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff ist es bevorzugt den Anteil des kohlenstoffhaltigen Gases zu erhöhen und den Anteil an Edelgas, insbesondere Argon zu senken.

Die während der Verfahrensschritte zum Aufdampfen der Haftschrift, Aufbringen der Uebergangsschicht und Abscheiden der Deckschicht am Substrat angelegte Substratbiasspannung kann insbesondere bei der Bildung der Uebergangsschicht und der Deckschicht eine Wechselspannung (AC), eine mit AC oder Puls überlagerte Gleichspannung (DC) bzw. modulierte Gleichspannung sein, wie insbesondere eine unipolare (negative) oder bipolare Substratbiasspannung sein, die in einem Mittelfrequenzbereich von 1 bis 10000 kHz, vorzugsweise 20 bis 250 kHz gepulst ist. Die Pulsform kann dabei symmetrisch beispielsweise sinus-, sägezahn-, oder rechteckförmig sein oder asymmetrisch, so dass lange negative und kurze positive Impulszeiten oder grosse negative und kleine positive Amplituden angelegt werden.

Darüber hinaus wird vorzugsweise während des gesamten Beschichtungsprozesses ein longitudinales Magnetfeld mit gleichmässigen Feldlinienverlauf eingestellt, wobei das Magnetfeld seitlich und/oder räumlich, kontinuierlich oder schrittweise veränderbar ist.

Vorzugsweise wird, falls für das Aufbringen der Haftschrift ein DC-Bias verwendet wurde, beim Aufbringen der Uebergangsschicht, zunächst an die Halterungsvorrichtung ein Mittelfrequenzgenerator angeschlossen, der seine Spannungsimpulse (Regelung über Steuerung der eingebrachten Leistung ist ebenfalls möglich, aber nicht bevorzugt) in Form eines sinus-, oder eines anderen bi- bzw. auch unipolaren Signalverlaufs abgibt. Der verwendete Frequenzbereich liegt hierbei zwischen 1 bis ca. 10.000 kHz, bevorzugt zwischen 20 und 250 kHz, die Amplitudenspannung zwischen 100 und 3.000 V, bevorzugt zwischen 500 und 2.500 V. Vorzugsweise wird der Wechsel der Substratspannung durch Umschalten eines eigens zur Abgabe von Gleich- und Mittelfrequenzspannung ausgelegten Generators durchgeführt. In einer anderen vorteilhaften Ausführungsform wird auch für die Durchführung des Aetz- und Haftbeschichtungsprozesses eine Mittelfrequenzspannung an die Substrate angelegt. Bei Verwendung einer bipolaren Substratspannung hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen asymmetrische Impulsformen anzulegen, beispielsweise kann der positive Impuls entweder kürzer oder mit einer kleineren Spannung als der negative Impuls angelegt werden, da die Elektronen rascher dem Feld folgen und auf Grund ihrer geringen Masse beim Auftreffen vor allem zu einer zusätzlichen Erwärmung der Teile führen, was besonders bei temperaturempfindlichen Grundwerkstoffen zu einer Schädigung durch Überhitzung führen kann. Dieser Gefahr kann auch bei anderen Signalverläufen durch Vorsehen einer sogenannten „OFF-Time“ entgegengewirkt werden, bei der zwischen dem Anlegen einzelner oder mehrerer Signalperioden mit Leistungsanteil (= „ON-Time“) ein Nullsignal angelegt wird.

Zeitgleich oder mit einer zeitlichen Verzögerung nach Anlegen des Mittelfrequenzsignals, bei Verwendung eines DC-Bias zum Aufbringen der Haftschrift, bzw. nach Aufdampfen

der für die Haftschrift gewünschten Schichtdicke bei Verwendung eines Mittelfrequenzbias, wird eine Kohlenwasserstoffgas, bevorzugt Acetylen mit einem schrittweise oder bevorzugt kontinuierlich ansteigenden Gasfluss in den Rezipienten eingelassen. Ebenso zeitgleich oder mit einer gegebenenfalls unterschiedlichen zeitlichen Verzögerung wird vorzugsweise die Leistung des mindestens einen metallischen oder Si-Targets schrittweise oder kontinuierlich heruntergefahren. Bevorzugt wird dabei das Target bis zu einer, je nach erreichtem Kohlenwasserstofffluss von einem Fachmann leicht zu bestimmenden Mindestleistung heruntergefahren, bei der noch ein stabiler Betrieb ohne Vergiftungserscheinungen durch das Reaktivgas möglich ist. Anschliessend wird das mindestens eine Target bevorzugt mit einer oder mehreren beweglich angeordneten Blenden gegen die Prozesskammer abgeschirmt, und abgeschaltet. Diese Massnahme verhindert weitgehend eine Belegung des Targets mit einer DLC-Schicht, womit auf ein sonst notwendiges Freisputtern zwischen einzelnen DLC-Beschichtungschichten verzichtet werden kann. Bei der nächsten durchzuführenden Charge genügt es ein Hochfahren des mindestens einen Targets bei geschlossenen Blenden vorzusehen, um wieder eine völlig blanke, für das Aufbringen der Haftschrift geeignete Targetoberfläche zu erzielen.

Ein wesentlicher Beitrag zur Stabilisierung des erfindungsgemässen DLC-Beschichtungsprozesses wird durch das Ausbilden eines longitudinalen Magnetfeldes erreicht. Dieses wird – wenn nicht schon im vorhergehenden Prozessschritt zum Aufbringen der Haftschrift verwendet – im wesentlichen zeitgleich mit dem Umschalten der Substratspannung auf den Mittelfrequenzgenerator erfolgen. Das Magnetfeld wird so ausgebildet, dass ein möglichst, gleichmässiger Feldlinienverlauf in der Prozesskammer gegeben ist. Dazu wird bevorzugt durch zwei im wesentlichen die Prozesskammer an gegenüberliegenden Seiten begrenzende elektromagnetische Spulen Strom so eingeleitet, dass an beiden Spulen ein gleichsinnig gerichtetes, sich gegenseitig verstärkendes Magnetfeld entsteht. Bei kleineren Kammerabmessungen kann eine ausreichende Wirkung gegebenenfalls auch mit nur einer Spule erzielt werden. Damit wird eine annähernd gleichmässige Verteilung des Mittelfrequenzplasmas über grössere Kammervolumen erreicht. Trotzdem kann es durch unterschiedliche Geometrien der zu beschichtenden Teile bzw. der Halterungsvorrichtungen immer noch vereinzelt zur Ausbildung von Nebenplasmen kommen, wenn bestimmte geometrische und elektromagnetische Randbedingungen erfüllt sind. Dem kann durch ein zeitlich und räumlich veränderbares Magnetfeld entgegengewirkt werden, indem die Spulenströme miteinander oder bevorzugt gegeneinander verschoben werden. Beispielsweise wird die erste Spule zunächst während 120 Sekunden durch eine stärkere Stromstärke I durchflossen als die zweite Spule. Während den darauf folgenden 90 Sekunden ist die Stromstärke invers, d.h. das zweite Magnetfeld ist stärker als das erste Magnetfeld. Diese Magnetfeldeinstellungen können periodisch, wie beschrieben, stufenweise oder kontinuierlich vorgenommen werden und damit durch geeignete Wahl der entsprechenden Spulenströme die Ausbildung von stabilen Nebenplasmen vermieden werden.

Erst durch die Verwendung des Magnetfelds und der dadurch erreichten signifikanten Erhöhung der Plasmaintensität ist im Gegensatz zum Stand der Technik möglich auch in niedrigen Druckbereichen von beispielsweise  $10^{-3}$  bis  $10^{-2}$  mbar einen stabilen CVD-Prozess zur Abscheidung von reinen DLC-Schichten mit hohen Abscheideraten im Bereich von 0,5 bis 5, bevorzugt zwischen 1 – 4  $\mu\text{m/h}$  zu erzielen. Neben dem Substratstrom ist dabei auch die Plasmaintensität direkt proportional zur Aktivierung des Magnetfeldes. Beide Parameter hängen zusätzlich von der Grösse der angebotenen, mit einem Bias beaufschlagten Flächen

ab. Durch die Anwendung niedriger Prozessdrücke können glattere Schichten, mit einer geringeren Anzahl von Wachstumsfehlern sowie geringerer Verunreinigung durch störende Fremdelemente, abgeschieden werden.

Die Wachstumsgeschwindigkeit hängt neben den Prozessparametern auch von der Beladung und der Halterung ab. Insbesondere wirkt sich hierbei aus ob die zu beschichtenden Teile 1-, 2- oder dreifach drehend, auf Magnethalterungen, oder geklemmt bzw. gesteckt befestigt werden. Auch die Gesamtmasse und Plasmadurchgängigkeit der Halterungen ist von Bedeutung, so werden beispielsweise mit leichtgebauten Halterungen, z.B. durch Verwendung von Speichentellern, statt Tellern aus Vollmaterial, höhere Wachstumsgeschwindigkeiten und eine insgesamt bessere Schichtqualität erzielt.

Zur weiteren Erhöhung des plasmaverstärkenden Magnetfelds können zusätzlich zu dem longitudinalen, die gesamte Prozesskammer durchdringenden Magnetfeld (Fernfeld) weitere lokale Magnetfelder – sogenannte Nahfelder – vorgesehen werden. Besonders vorteilhaft ist dabei eine Anordnung bei der zusätzlich zu mindesten einem Magnetronmagnetsystem des mindesten einen Targets weitere bevorzugt permanente Magnetsysteme an den die Plasmakammer begrenzenden Wänden angebracht werden, die eine ähnliche oder die gleiche magnetische Wirkung wie das mindesten eine Magnetronmagnetsystem haben. Dabei kann entweder bei allen Magnetron- und weiteren Magnetsystemen derselbe Aufbau oder aber bevorzugt eine Umkehrung der Polungen vorgenommen werden. Dadurch ist es möglich die einzelnen Nahfelder der Magnet- bzw. Magnetronmagnetsysteme gleichsam als einen die Prozesskammer umgebenden magnetischen Einschluss auszubilden um somit eine Absorption der freien Elektronen an den Wänden der Prozesskammer zu verhindern.

Erst durch eine Kombination der wesentlichen Merkmale des erfinderischen Verfahrens ist es möglich, eine wie oben beschriebene Schicht herzustellen. Erst der Einsatz von durch Magnetfelder stabilisierten Plasmen sowie der abgestimmte Einsatz der Substratbiasspannung ermöglicht die Verwendung der für übliche PVD-Prozesse optimierten Halterungen mit hoher Packungsdichte und Prozesssicherheit. Das Verfahren zeigt, wie der Ablauf bzw. die Kombination von Gleichstrom- und Mittelfrequenzplasmen in optimaler Weise für die Abscheidung einer DLC-Schicht eingesetzt werden kann.

Zum Aufbau der unterschiedlichen Gleitschichten werden verschiedene Verfahren angewandt.

Zum Abscheiden einer **graphitisierten DLC-Schicht** wird nach Aufbringen der reinen DLC-Schicht, bei sonst im wesentlichen gleich oder ähnlich eingestellten Prozessparametern, die Biasspannung entweder stufenweise oder kontinuierlich auf einen Wert über 2000 V, vorzugsweise zwischen 2000 und 2500 V eingestellt. Mit steigender Spannung wächst dabei der Anteil der in graphitischer  $sp^2$ -Bindung aufwachsenden C-Atome. Damit können, in besonders einfacher Weise, der davor abgeschiedenen reinen DLC-Schicht verbesserte Gleiteigenschaften verliehen werden.

Zum Aufbringen einer **inverse Gradientenschicht** gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Im einfachsten Fall kann der Prozess zunächst unter Beibehaltung derselben Parameter wie



bei der vorhergehenden DLC-Schicht unter Zuschalten eines oder mehrere metallischen, bzw. metallkarbidischen. Als vorteilhaft hat es sich jedoch erwiesen, zunächst entweder den Kohlenwasserstoffanteil im Gasfluss zu erniedrigen, den Edelgasanteil zu erhöhen oder beide Massnahmen gemeinsam durchzuführen, um ein Vergiften der Targets und damit instabile Prozesszustände zu vermeiden. Weiters kann ein Anfahren der Targets hinter zunächst geschlossenen Blenden von Vorteil sein um eventuelle Droplets auf den Substraten zu vermeiden. Anschliessend wird die Leistung des mindestens einen Targets stufenweise oder bevorzugt kontinuierlich bis auf einen Wert erhöht, bei dem die Schicht bestimmte erwünschte Schichteigenschaften (Reibbeiwert, ... ) aufweist. Die übrigen Parameter werden bevorzugt unverändert belassen, jedoch ist eine zusätzliche Anpassung falls gewünscht jederzeit möglich. Anschliessend wird der Prozess noch bevorzugt unter Konstanzhaltung der Einstellung zu Ende geführt, bis eine gewünschte Schichtdicke der inversen Gradientenschicht erreicht ist.

Eine weitere vorteilhafte Möglichkeit zur Ausbildung einer inversen Gradientenschicht ergibt sich wenn zusätzlich zu oder statt des erwähnten Kohlenwasserstoffgases noch siliziumhaltige bzw. silizium- und sauerstoff- bzw. stickstoffhaltige Gase, wie beispielsweise Mono- und Disilane, Siloxane, Hexamethyldisiloxan, Hexamethyldisilazan, Dimethyldiethoxysilan, Tetramethylsilan etc. eingelassen werden um die Eigenschaften der Schicht, insbesondere deren Härte und Reibkoeffizienten zu beeinflussen. Damit ist es auch möglich ohne zusätzliches Einschalten eines oder mehrerer Sputtertargets eine Gradientenschicht mit beispielsweise zur Oberfläche hin ansteigendem Silizium-, Sauerstoff- und /oder Stickstoffgehalt herzustellen.

Das Aufbringen einer Gleitschicht als **Gradientendeckschicht**, kann entweder direkt auf einer DLC-Schicht oder nach Aufbringen einer metallischen bzw. karbidischen Zwischenschicht erfolgen.

Beispielsweise wird für die Erzeugung der reibmindernden Deckschicht die dazu verwendete mindestens eine Quelle, ähnlich wie bereits oben beschrieben, allerdings nach stärkerem gegebenenfalls auf 0% Absenken des Kohlenstoffgehalts des Prozessgases eingeschaltet. Zur Herstellung der reibmindernden Deckschicht können karbidische oder metallische Targets verwendet werden, wobei die karbidischen Targets den Vorteil bieten einen insgesamt höheren C-Gehalt, bei sehr hoher Belastbarkeit der Schichten zu ermöglichen. Der Gehalt an graphitischem Kohlenstoff wird wiederum durch Einlassen eines C-haltigen Reaktivgases eingestellt, wobei vorteilhafterweise der Gasfluss ab Einschalten der zur Herstellung der MeC/C-Schicht verwendeten Targets, oder mit einer zeitlichen Verzögerung, mittels einer Rampenfunktion erhöht und am Schluss der Beschichtung für eine bestimmte Zeit konstant gehalten wird.

Eine besonders vorteilhafte Ausführung der Schicht ergibt sich, wenn auf der DLC-Schicht zunächst eine dünne (0.01 - 0.9 µm) karbidische, wie zum Beispiel WC-Schicht abgeschieden wird. Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass gerade karbidische Schichten besonders gut als Haftvermittler auf einer bereits abgelegte DLC-Schicht geeignet sind. Nach aussen hin wird der Schichtaufbau von einer WC/C-Schicht mit einem zunehmenden C-Gehalt und einer Dicke von ca. 0.1-5 µm abgeschlossen. Vorteilhafterweise wird die Schichtdicke der MeC/C-Schicht geringer als die der reinen DLC-Schicht gewählt.

16

Eine weitere bevorzugte Ausführung eines erfinderischen DLC-Gleitschichtsystems ergibt sich wenn die abschliessende Gleitschicht auf einer Diamantschicht aufgebracht wird, die beispielsweise mittels einer Hochstromniedervoltbogenentladung oder der Hot-Filament-Technik abgeschieden wurde.

## ANLAGE

Weiterhin wird die oben erwähnte Aufgabe durch Bereitstellung einer Vorrichtung zur Durchführung des Beschichtungsverfahrens nach einem der Merkmalssätze 10 bis 26 gelöst, wobei die Vorrichtung eine Vakuumkammer mit einem Pumpsystem zur Erzeugung eines Vakuums in der Vakuumkammer, Substrathalterungen zur Aufnahme der zu beschichtenden Substrate, mindestens einer Gasversorgungseinheit zum Zudosieren von Prozessgas, mindestens eine Verdampfer-Vorrichtung zur Bereitstellung von Beschichtungsmaterial zum Aufdampfen, eine Lichtbogenerzeugungseinrichtung zum Zünden eines Gleichspannungsniedervoltbogens, eine Vorrichtung zur Erzeugung einer Substratbiasspannung und mindestens eine oder mehrere Magnetfelderzeugungseinrichtungen zur Ausbildung eines magnetischen Fernfelds umfasst.

Vorzugsweise werden die Magnetfelderzeugungseinrichtungen durch mindestens eine Helmholtzspule, vorzugsweise ein Paar von Helmholtzspulen gebildet.

Bei der Verwendung von Helmholtzspulen ist das erzeugbare Magnetfeld bzw. die Magnetflussdichte durch die Stromstärke in den Spulen sowohl örtlich als auch zeitlich steuerbar.

Eine weitere Möglichkeit zur Erzeugung eines longitudinalen Magnetfeldes ergibt sich, wenn zwei Magnetrons an gegenüberliegenden Seiten des Rezipienten angeordnet werden, und diesen zusätzlich zumindest jeweils eine elektromagnetische Spule zugeordnet ist. Die jeweils zugeordnete Spule wird vorteilhafterweise so angebracht, dass sie im wesentlichen den gesamten seitlichen Umfang der Magnetronanordnung begrenzt. Die Polungen der gegenüberliegenden Magnetronmagnetsysteme werden dabei gegengleich ausgerichtet, d.h. dem Nordpol des einen Systems steht ein Südpol des anderen Systems gegenüber und umgekehrt. Gleichzeitig werden die jeweils zugeordneten Spulen so an eine Stromquelle angeschlossen, dass sich die Felder der Magnetspulen entsprechend einer Helmholtzanordnung zu einem geschlossenen Magnetfeld ergänzen und die Polung der Aussenpole der Magnetronmagnetsysteme und der Magnetspulen gleichsinnig ist. Derartige Vorrichtungen lassen sich vorteilhaft sowohl zur Verstärkung des Magnetronplasmas als auch zur Erhöhung der Ionisation während des Plasma-CVD-Prozesses einsetzen.

Weiterhin umfasst die Vorrichtung eine Vorrichtung zur Erzeugung einer Substratbiasspannung, die kontinuierlich oder schrittweise die angelegte Substratbiasspannung verändern kann und entsprechend auch bipolar oder unipolar betreibbar ist. Insbesondere ist die Vorrichtung geeignet, eine im Mittelfrequenzbereich gepulste Substratbiasspannung zu erzeugen.

Die bei der Vorrichtung verwendeten Verdampfvorrichtungen umfassen Sputtertargets, insbesondere Magnetronsputtertargets, Arcquellen, thermische Verdampfer und dergleichen. Vorteilhaft dabei ist, dass die Verdampfervorrichtung von der übrigen Prozesskammer beispielsweise durch schwenkbare Blenden abtrennbar ist.

Die Vorrichtung weist vorteilhafterweise eine Substratheizung in Form einer induktiven Heizung, Strahlungsheizung oder dergleichen auf, um die Substrate in einem Heizschritt vor der Beschichtung reinigen zu können. Bevorzugt wird aber das Zünden eines Plasmas verwendet.

Unter anderem dazu ist in der Vorrichtung eine Niedervoltbogenerzeugungseinrichtung vorgesehen, die eine Ionenquelle mit einem Filament, vorzugsweise einem Refraktärfilament, insbesondere aus Wolfram, Tantal oder dergleichen in einer Ionisationskammer sowie eine Anode und eine Gleichspannungsversorgung umfasst. Die Ionenquelle ist hierbei mit dem negativen Pol der Gleichspannungsversorgung verbunden. Vorzugsweise kann der positive Pol der Gleichspannungsversorgung wahlweise mit der Anode oder den Substrathalterungen verbunden sein, so dass ein Niedervoltlichtbogen zwischen Ionenquelle und Anode oder Ionenquelle und Substraten gezündet werden kann. Auch die Ionenquelle ist ähnlich wie die Verdampfer-Vorrichtung von der eigentlichen Prozesskammer abtrennbar, z.B. durch eine Lochblende, z.B. aus Wolfram, Tantal oder einem ähnlichen Refraktärmetall.

Um einen gleichmässigen Beschichtungsprozess für alle Seiten der Substrate zu ermöglichen, ist es weiterhin vorgesehen, dass die Substrathalterungen beweglich sind und sich vorzugsweise um mindestens eine oder mehrere Achsen drehen können.

Durch die vorteilhafte Kombination der mittelfrequenten Substratspannungsversorgung und einer Helmholtz-Spulenordnung, die auch durch seitlich angebrachte, zwei gegenüberliegende Targets umfassende Spulen verwirklicht werden kann, ist es erstmals im industriellen Massstab möglich auch bei tiefen Drücken ein stabiles Mittelfrequenzplasma zur Durchführung eines DLC-Prozesses zu nutzen. Die damit hergestellten Schichten weisen im Gegensatz zu mit anderen Systemen hergestellten DLC-Schichten stark verbesserte Eigenschaften auf.

Mit vorliegender Beschichtungsanlage und dem oben beschriebenen Verfahren lassen sich erstmals dicke reine DLC-Schichten mit ausgezeichneter Haftung herstellen. Zusätzlich kann bei Änderung der Verfahrensparameter auch ein Grossteil der bisher bekannten Plasmaprozeduren zur Herstellung von Metallkohlenstoff- oder Mischschichten mit anderen Elementen wie z.B. Silizium oder F und zur Herstellung von Mehrlagenschichten oder von einfachen, bekannten, mittels PVD- und/oder CVD-Verfahren abgeschiedene Schichtsystemen durchgeführt werden.

Weiters lassen sich zusätzlich DLC-Gleitschichtsysteme mit einstellbarem Gleit- und Einlaufverhalten abscheiden.

Q

Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale von DLC-Gleitschichtsysteme sind in den der Beschreibung angefügten Merkmalssätzen enthalten.

Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale der Erfindung werden anhand der nachfolgenden detaillierten Beschreibung von bevorzugten Ausführungsformen anhand der beige-fügten Zeichnungen deutlich. Dabei zeigen die Figuren sämtlich in rein schematischer Weise in

- |          |   |
|----------|---|
| Figur 1  | eine erfindungsgemässe Vorrichtung im Querschnitt           |
| Figur 2  | die erfindungsgemässe Vorrichtung der Figur 1 in Draufsicht |
| Figur 3  | Einfluss des Spulenstroms auf den Substratstrom             |
| Figur 4  | Prozessparameter Gradientenschicht                          |
| Figur 5  | Prozessparameter DLC-Schicht                                |
| Figur 6  | REM-Bruchaufnahme einer erfindungsgemässen DLC-Schicht      |
| Figur 7  | Prozessparameter Gesamtverlauf                              |
| Figur 8  | Prozessparameter graphitisierte DLC-Schicht                 |
| Figur 9  | Prozessparameter inverse Gradientenschicht                  |
| Figur 10 | Prozessparameter Gradientenschicht                          |
| Figur 11 | Prozessparameter H <sub>2</sub> -reiche Schicht             |

FIG. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch die Prozesskammer 1 einer erfindungsgemässen Beschichtungsanlage. Die zu beschichtenden Teile 2 sind auf einer bzw. mehreren Halterungsvorrichtungen 3 montiert, die Mittel zur Erzeugung einer zumindest einfachen 4, bei Bedarf auch zweifachen 5 Rotation der Teile umfasst. In einer besonders vorteilhaften Ausführung werden die Halterungsvorrichtungen 3 auf einem zusätzlich um die Anlagenachse 6 drehbaren Karussell 7 positioniert.

Über Gaseinlässe 8 können die unterschiedlichen Prozessgase, insbesondere Ar und Azetylen, in die Prozesskammer mittels geeigneter, hier nicht dargestellten Regelvorrichtungen zugeführt werden.

Ein hochvakuumtauglicher Pumpstand 9 ist an die Kammer angeflanscht.

Eine Ionenquelle 10 ist vorzugsweise im Bereich der Anlagenachse angeordnet, die an den negativen Ausgang einer Gleichspannungsversorgung 11 angeschlossen ist. Der positive Pol der Gleichspannungsversorgung 11 kann je nach Prozessschritt über einen Schalter 12 an das Karussell 7 bzw. an die Halterungsvorrichtung 3 und die damit elektrisch verbundenen Teile 2 (Heizprozess) oder an die Hilfsanode 13 (Ätzprozess, bzw. bei Bedarf auch während der Beschichtungsprozesse) angelegt werden.

An den Wänden der Prozesskammer 1 ist mindestens eine Verdampferquelle 14, bevorzugt ein Magnetron oder ein Lichtbogenverdampfer zum Aufbringen der Haft- und Gradientenschicht vorgesehen. In einer anderen hier nicht dargestellten Ausführungsform der Verdampferquelle 14 kann diese als anodisch geschalteter Tiegel zentral im Boden der Prozesskammer 1 angebracht sein. Dabei wird das Verdampfungsgut zur Herstellung der Uebergangs- oder Gradientenschicht mittels Erhitzen durch den Niedervoltbogen 15 in die Gasphase übergeführt.

Ferner ist eine zusätzliche elektrische Spannungsversorgung 16 vorgesehen, mit deren Hilfe an die Substrate eine periodisch veränderliche Mittelfrequenzspannung im Bereich zwischen 1-10.000, bevorzugt zwischen 20 und 250 kHz angelegt werden kann.

Die elektromagnetischen Spulen 17 zur Erzeugung eines longitudinalen, den Plasmaraum durchdringenden Magnetfelds sind an gegenüberliegenden Begrenzungswänden der Prozesskammer 1 angeordnet und werden durch mindestens eine, vorzugsweise zwei getrennte, hier nicht näher dargestellte DC-Spannungsquellen gleichsinnig gespeist.

Alle Beschichtungsversuche wurden auf einer ähnlich FIG. 1 ausgeführten Prozesskammer folgender Abmessungen durchgeführt:

Kammerhöhe 920 mm, Durchmesser 846 mm, Volumen 560 l.

Als zusätzliche Massnahmen zur Verstärkung bzw. gleichmässigeren Ausformung des Magnetfelds und damit des MF-Plasmas 18 können an den Seitenwänden 19 der Plasmakammer 1 Magnetsysteme 20 zur Ausbildung mehrerer magnetischer Nahfelder 21 angebracht werden. Dabei werden vorteilhafterweise gegebenenfalls unter Einbeziehung des mindestens einen Magnetronmagnetsystems 22, wie beispielsweise in FIG. 2 dargestellt, abwechselnd Magnetsysteme mit NSN bzw. SNS Polung angeordnet und damit ein magnetischer tunnelförmiger, schleifenförmiger Einschluss des Plasmas in der Prozesskammer bewirkt.

Bevorzugterweise werden die Magnetsysteme 20 für die Nahfelderzeugung als Magnetronmagnetsysteme ausgebildet.

Die einzelnen Systeme der Beschichtungsanlage werden vorteilhafterweise durch eine Prozesssteuerung miteinander in Beziehung gesetzt. Damit ist es möglich, neben den Grundfunktionen einer Vakuumbeschichtungsanlage (Pumpstandsteuerung, Sicherheitsregelkreise, etc.), die verschiedenen plasmaerzeugenden Systeme wie Magnetrons mit der hier nicht näher beschriebenen Magnetronversorgung, Ionisationskammer 1 und Hilfsanode 13 bzw. Karussell 7 und Gleichspannungsversorgung 11, sowie Karussell 7 und Mittelfrequenzgenerator 16, sowie die entsprechende Einstellung der Gasflüsse, sowie die Steuerung der gegebenenfalls unterschiedlichen Spulenströme in flexibler Weise aneinander anzupassen und für unterschiedliche Prozesse zu optimieren.

Figur 3 zeigt den Zusammenhang zwischen Substratstrom und Spulenstrom bei Verwendung von Helmholtzspulen zum Aufbau eines Magnetfeldes. Es zeigt sich, dass der Substratstrom, und damit die Plasmaintensität direkt proportional zum Spulenstrom und damit zum Magnetfeldaufbau sind. Dies zeigt deutlich die positive Wirkung eines überlagerten Magnetfeldes.

In Figur 4 wird beispielhaft der Verlauf einzelner Parameter während des Aufbringens einer Gradientenschicht dargestellt: Bei sonst gegenüber der Haftschrift gleich bleibenden Parametern wird der Substratbias von Gleichstrom auf Mittelfrequenz mit einer bevorzugten Amplitudenspannung zwischen 500 und 2500 V und einer Frequenz zwischen 20 und 250 kHz, umgeschaltet. Nach ca. 2 Minuten wird eine Acetylenrampe bei 50 sccm gestartet und über ca. 30 Minuten auf 350 sccm gefahren. Ca. 5 Minuten nach Einschalten des Mittelfrequenzgenerators wird die Leistung der verwendeten Cr-Targets auf 7 kW, nach weiteren 10 Minuten auf 5 kW zurückgenommen, und dort noch 2 Minuten konstant gehalten. Anschließend werden Blenden vor die Targets gefahren und diese abgeschaltet, womit die Abscheidung der im wesentlichen aus Kohlenstoff-, in geringen Mengen Wasserstoff und noch geringeren Mengen Argonatomen aufgebauten „reinen“ DLC-Schicht beginnt.

Dazu kann im einfachsten Fall der Prozess mit ausgeschalteten Bedampfungsquellen, im übrigen aber gleichen Parametern wie bei der vorhergehenden Gradientenschicht zu Ende geführt werden. Als vorteilhaft hat es sich jedoch erwiesen, im Laufe der Abscheidung der reinen DLC-Schicht entweder den Kohlenwasserstoffanteil im Gasfluss zu erhöhen, den Edelgasanteil abzusenken oder besonders bevorzugt beide Massnahmen gemeinsam durchzuführen. Auch hier kommt wieder einer, wie oben beschriebenen Ausbildung eines longitudinalen Magnetfeldes eine besondere Bedeutung zur Erhaltung eines stabilen Plasmas zu.

In den Figuren 4 und 5 wird beispielhaft der Verlauf einzelner Parameter während des Aufbringens der reinen DLC-Schicht dargestellt: Nach Abschalten der verwendeten Cr-Targets wird bei gleichbleibend eingestellter Mittelfrequenzversorgung und gleichbleibendem Argonfluss die während der Gradientenschicht begonnene Acetylenrampe ca. 10 Minuten gleichförmig bis zu einem Fluss zwischen ca. 200 – 400 sccm gesteigert. Anschließend wird der Argonfluss über einen Zeitraum von 5 Minuten kontinuierlich auf einen Fluss zwischen ca. 0 – 100 sccm zurückgenommen. Die nächsten 55 Minuten wird der Prozess bei gleichbleibenden Einstellungen zu Ende gefahren.

Figur 6 zeigt eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Bruchfläche eines erfindungsgemässen DLC-Schichtsystems. Deutlich ist zu erkennen, dass im Bereich der Deckschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff eine feinkörnige Struktur vorliegt, so dass die DLC-Schicht einen polykristallinen Charakter aufweist.

Figur 7 zeigt beispielhaft den Gesamtverlauf einzelner Prozessparameter während des Aufbringens eines erfinderischen DLC-Schichtsystems.

Figur 8 zeigt beispielhaft den Gesamtverlauf einzelner Prozessparameter während des Aufbringens eines erfinderischen DLC-Gleitschichtsystems mit graphitisierter Gleitschicht. Dazu wird nach Aufbringen der DLC-Schicht, je nach gewünschter Schichtdicke beispielsweise nach 33 bis 60 Minuten Beschichtungsdauer, bei sonst gleichbleibenden Prozessparametern, der gepulste Substratbias mittels einer Spannungsrampe auf einen Wert zwischen 1500 und 2500 V eingestellt und anschliessend unter konstanten Bedingungen eine Einlaufschicht abgeschieden.

Figur 9 zeigt beispielhaft den Gesamtverlauf einzelner Prozessparameter während des Aufbringens eines erfinderischen DLC-Gleitschichtsystems mit einer inversen Gradientenschicht. Dazu wird nach Aufbringen der DLC-Schicht, je nach gewünschter Schichtdicke beispielsweise nach 33 bis 60 Minuten Beschichtungsdauer, die Leistung das mindestens einen Targets hinter geschlossenen Blenden 10 Minuten, mit 5 kW, hinter den Blenden freigesputtert, anschliessend die Blenden geöffnet und innerhalb von ca. 20 Minuten auf 7 kW hochgefahren. Gleichzeitig wird die Acetylenrampe beispielsweise bei 350 sccm gestartet und über ca. 30 Minuten auf 50 sccm gefahren. Anschliessend wird der Prozess noch bevorzugt unter Konstanthaltung der Einstellungen zu Ende geführt, bis eine gewünschte Schichtdicke der Einlaufschicht erreicht ist.

Figur 10 zeigt beispielhaft den Verlauf einzelner Prozessparameter während des Aufbringens einer Gradientenschicht als Gleitschicht. Diese kann ähnlich wie die Übergangsschicht, allerdings auch ohne metallische Haftschrift, ausgeführt werden. Vorteilhafterweise wird auch hier eine Einlaufschicht mit konstanten Parametern als Schichtabschluss vorgesehen.

Figur 11 zeigt beispielhaft den Gesamtverlauf einzelner Prozessparameter während des Aufbringens eines erfinderischen DLC-Gleitschichtsystems mit einer H<sub>2</sub>-reichen Gleitschicht. Dazu wird nach Aufbringen der DLC-Schicht, eine Methanrampe gestartet und beispielsweise über ca. 30 Minuten von 0 auf 100 sccm gefahren. Gleichzeitig wird eine Acetylenrampe beispielsweise bei 350 sccm gestartet und über ca. 30 Minuten auf 120 sccm heruntergefahren. Die Einlaufschicht wird als Schichtabschluss mit konstanten Parametern gefahren.

## Ausführung der Erfindung im Beispiel

### Prozessbeispiele 1

#### Heizprozess

Die Prozesskammer wird bis auf einen Druck von etwa 10-5 mbar abgepumpt und die Prozessfolge gestartet. Als erster Teil des Prozesses wird ein Heizprozess durchgeführt, um die zu beschichtenden Substrate auf eine höhere Temperatur zu bringen und von flüchtigen Substanzen an der Oberfläche zu befreien. Bei diesem Prozess wird ein Ar-Wasserstoff-Plasma mittels des Niedervoltbogens zwischen der Ionisationskammer und einer Hilfsanode gezündet. Die folgende Tabelle 1 zeigt die Prozessparameter des Heizprozesse:

Ar-Fluss	75 sccm
Substrat-Bias Spannung [V]	0
Strom des Niedervoltbogens	100 A
Wasserstoff-Fluss	170 sccm
Strom obere Spule	Schwellend zwischen 20 und 10 A
Strom untere Spule	Gegengleich schwellend zwischen 20 und 5 A
Periodendauer zwischen max. und min. Spulenstrom	1.5 min
Heizzeit	20 min

Die Helmholtzspulen werden zur Aktivierung des Plasmas eingesetzt und werden zyklisch angesteuert. Der Strom der oberen Spule wird dabei mit einer Periodendauer von 1.5 min zwischen 20 und 10 A variiert, der Strom der unteren Spule wechselt im selben Takt gegengleich zwischen 5 und 20 A.

Dabei erwärmen sich die Substrate und die störenden an der Oberflächen anhaftenden flüchtigen Substanzen werden in die Gasatomsphäre getrieben, wo sie von den Vakuumpumpen abgesaugt werden.



**Aetzprozess**

Wenn eine gleichmässige Temperatur erreicht ist, wird ein Aetzprozess gestartet, indem die Ionen aus dem Niedervoltbogen mittels einer negativen Biasspannung von 150V auf die Substrate gezogen werden. Die Ausrichtung des Niedervoltbogens und Intensität des Plasmas werden dabei von dem in horizontaler Ausrichtung angebrachten Helmholtzspulenpaar unterstützt. Folgende Tabelle zeigt die Parameter des Aetzprozesses.

Ar-Fluss	75 sccm
Substratspannung	-150 V
Niedervolt-Bogenstrom	150 A

**Cr-Haftschrift**

Mit der Aufbringung der Cr-Haftschrift wird begonnen, indem die Cr-Magnetron-Sputtertargets aktiviert werden. Der Ar-Gasfluss wird auf 115 sccm eingestellt. Die Cr-Sputter-Targets werden mit einer Leistung von 8 kW angesteuert und die Substrate werden nun für eine Zeit von 6 min an den Targets vorbei rotiert. Der sich einstellende Druckbereich liegt dann zwischen 10-3 mbar und 10-4 mbar. Der Sputterprozess wird durch die Zuschaltung des Niedervoltbogens und das Anlegen einer negativen DC-Biasspannung von 75 V am Substrat unterstützt.

Nach der Hälfte der Cr-Sputterzeit wird der Niedervoltbogen abgeschaltet und die Abscheidung wird für den Rest der Cr-Sputterzeit nur mit Hilfe des vor den Cr-Targets aktiven Plasmas getätigt.

**Gradientenschicht**

Nach Ablauf dieser Zeit wird durch Einschalten eines Sinusgenerators ein Plasma gezündet. Acetylgas mit einem Anfangsdruck von 50 sccm eingelassen und der Fluss jede Minute um 10 sccm erhöht.

Der Sinus-Plasmagenerator wird dabei bei einer Frequenz von 40 kHz auf eine Amplitudenspannung von 2400 V eingestellt. Der Generator zündet zwischen den Substrathalterungen und der Gehäusewand eine Plasmaentladung. Die am Rezipienten angebrachten Helmholtzspulen sind dabei beide mit einem konstanten Stromdurchfluss von 3 A in der unteren Spule und 10 A in der oberen Spule aktiviert. Bei einem Acetylenfluss von 230 sccm werden die Cr-Targets deaktiviert.

24

**DLC-Beschichtung**

Wenn der Fluss des Acetylen den Wert von 350 sccm erreicht hat, wird der Ar Fluss auf einen Wert von 50 sccm reduziert.

Die Tabelle zeigt die Parameter des Beispiels im Überblick:

Fluss Argon	50 sccm
Fluss Acetylen	350 sccm
Anregungsstrom obere Spule	10 A
Anregungsstrom untere Spule	3 A
Spannungsamplitude	2400 V
Anregungsfrequenz f	40 kHz

Bei diesen Verhältnissen ist eine hohe Abscheiderate gewährleistet und die Ionisierung des Plasmas wird mit Hilfe des Ar-Gases aufrechterhalten. Die Abscheiderate die sich nun im Beschichtungsprozess einstellt, wird sich im Bereich zwischen 0.5 und 4  $\mu\text{m/h}$  belaufen, was auch von der zu beschichtenden Fläche in der Prozesskammer abhängt.

Nach Ablauf der Beschichtungszeit wird der Sinus-Generator und der Gasfluss abgestellt, und die Substrate der Prozesskammer entnommen.

Die Eigenschaften der entstehenden Schicht sind der folgenden Tabelle zu entnehmen

Eigenschaften Beispiel 1	
Mikrohärte	ca. 2200 HK
Abscheiderate	1-2 $\mu\text{m/h}$
Haftung	HF1
Widerstand	<10 k $\Omega$
Wasserstoffgehalt	12%
Reibkoeffizient	0.2
Innere Spannung	ca. 2 GPa
Bruchverhalten	Nicht glasig

25

**Prozessbeispiel 2**

Prozessbeispiel 2 sieht eine Durchführung ähnlich Beispiel 1 vor. Im Unterschied zu Beispiel 1 wird das Plasma von einem Pulsgenerator erzeugt. Die Anregungsfrequenz liegt bei 50 kHz mit einer Amplituden-Spannung von 700V.

Die Tabelle zeigt die Parameter des 2. Beispiels.

Fluss Argon	50 sccm
Fluss Acetylen	350 sccm
Anregungsstrom obere Spule	10 A
Anregungsstrom untere Spule	3 A
Spannungsamplitude	700 V
Anregungsfrequenz f	40 kHz

Die erzeugte Beschichtung weist eine Härte von 25 GPa, eine Haftfestigkeit von HF1 auf und ergibt einen Reibbeiwert von 0.2.

Eigenschaften Beispiel 2	
HK	ca. 2400
Abscheiderate	ca. 1.5µm/h
Haftung	HF1
Widerstand	> 500 kΩ
Wasserstoffgehalt	13%
Reibkoeffizient	0.2
Innere Spannung	Ca. 3 GPa

**Prozessbeispiel 3**

Prozessbeispiel 3 sieht eine Durchführung ähnlich Beispiel 1 vor. Im Unterschied zu Beispiel 1 wird das Plasma von einer uni-polaren Pulsspannung angeregt, die Parameter des Versuchs zeigt folgende Tabelle.

Fluss Argon	50 sccm
Fluss Acetylen	350 sccm
Anregungsstrom obere Spule	10 A
Anregungsstrom untere Spule	3 A
Spannungsamplitude	1150 V
Anregungsfrequenz f	30 kHz

26

Die erzeugte Beschichtung weist die in der folgenden Tabelle beschriebene Eigenschaften auf.

Eigenschaften Beispiel 3	
Mikrohärte	> 2500 HK
Abscheiderate	ca. 1.8 $\mu\text{m/h}$
Haftung	HF1
Widerstand	> 1 k $\Omega$
Wasserstoffgehalt	12-16%
Reibkoeffizient	0.2
Innere Spannung	ca. 2 GPa

#### Prozessbeispiel 4

In Vergleich zu Prozessbeispiel 1 wurde im Beispiel 4 ein Prozess ohne Unterstützung durch ein longitudinales Magnetfeld durchgeführt. Der die beiden Spulen durchfließende Strom wurde auf einen Wert von 0 A reduziert. Die Tabelle zeigt die Prozessparameter.

Fluss Argon	50 sccm
Fluss Acetylen	350 sccm
Anregungsstrom obere Spule	0 A
Anregungsstrom untere Spule	0 A
Spannungsamplitude	2400 V
Anregungsfrequenz f	40 kHz

Es stellt sich ein Plasma ein, das gegenüber Beispiel 1 erst bei höheren Drücken als bei Beispiel 1 stabil ist, inhomogen über die Prozesskammer verteilt ist und von geometrischen Effekten sehr stark beeinflusst ist. Deshalb kommt es zu einer in der Prozesskammer inhomogenen und wegen der bei dem eingestellten Prozessdruck gegenüber Beispiel 1 geringeren Abscheiderate. Bei den angestrebten Prozessdrücken war eine Plasmabildung ohne den Einsatz einer zweiten Plasmaquelle wie z.B. einem Target oder dem Zuschalten des Filamentes nicht möglich. Erst durch den Einsatz der Helmholtzspulen konnte das Plasma in der Prozesskammer stabilisiert werden und eine homogene Abscheidung über die Höhe der Prozesskammer erreicht werden. Ohne den Einsatz der Spulen zündete ein Plasma im Bereich der Ionisationskammer, wo lokal hohe Temperaturen erzeugt werden und Zerstörung befürchtet werden muss.

27

Eigenschaften Beispiel 4	
HK	Inhomogen 1200 – 2500
Abscheiderate	Inhomogen
Haftung	Nicht bestimmbar
Widerstand	Inhomogen

### Gleitschichtsysteme

Im Folgenden wurden auf die wie oben beschriebene DLC-Schichten unterschiedliche Gleitschichten aufgebracht, um ein erfindungsgemässes Schichtsystem herzustellen. Dabei ist darauf zu achten, dass der alle Plasmavorbehandlungen und Beschichtungsschritte enthaltende Prozess durchgehend ohne Unterbrechung des Vakuums gefahren wird, um eine optimale Schichthaftung zu erreichen.

Tabelle 5 zeigt verschiedene Prozessbeispiele mit einer jeweils graphitisierten Gleitschicht:

Prozessbeispiel	5	6	7
DLC-Schichtsystem Beispiel	wie 1 aber Spannungsampl. 1000V	2	3
Fluss Argon	50 sccm	50 sccm	50 sccm
Fluss Acetylen	350 sccm	350 sccm	350 sccm
Anregungsstrom obere Spule	10 A	10 A	10 A
Anregungsstrom untere Spule	3 A	3 A	3 A
Substrat-Spannungsamplitude	2400 V	2400 V	2400 V
Rampe Spannung	15 min	25 min	15 min
Anregungsfrequenz f	40 kHz	40 kHz	30 kHz
Anregungstyp	AC-Sinus	bipolarer Puls	unipolarer Puls

28

**Tabelle 6** zeigt verschiedene Möglichkeiten zur Ausbildung einer Gleitschichten wie z.B. eine abschliessenden Gradientenschicht (Nr.8), einer inversen Gradientenschicht (Nr.9), bzw. einer wasserstoffreichen C-Schicht (Nr.10):

Prozessbeispiel	8*	9	10
DLC-Schicht Nr.	3	2	2
Fluss Argon 1	30 sccm	50 sccm	50 sccm
Fluss Argon 2	30 (100) sccm	-	-
Rampe Argon	0 (10) min	-	-
Fluss Acetylen 1	0 sccm	350 sccm	350 sccm
Fluss Acetylen 2	250 sccm	180 sccm	150 sccm
Rampe Acetylen	15 min	20 min	20 min
Fluss Methan 1	-	-	0 sccm
Fluss Methan 2	-	-	150 sccm
Rampe Methan	-	-	20 min
Leistung Cr-Target 1	8 kW	7 kW	-
Leistung Cr-Target 2	7 kW	-	-
Rampe Cr-Target	20 min	30 min	-
Anregungsstrom obere Spule	10 A	10 A	10 A
Anregungsstrom untere Spule	3 A	3 A	3 A
Substrat-Spannungsamplitude	2400 V	700 V	1150 V
Anregungsfrequenz f	40 kHz	40 kHz	30 kHz
Anregungstyp	AC-Sinus	bipolarer Puls	unipolarer Puls

\* Die Acetylenrampe kann hierbei auch mit einer zeitlichen Verzögerung von 5-10 min nach Einschalten der Cr-Targets gestartet werden. Ein solches Vorgehen ist besonders vorteilhaft, wenn DLC- und Gleitschicht in unterschiedlichen Prozesskammern oder Beschichtungsanlagen aufgebracht werden. Dabei kann auch an Stelle des Sinusgenerators eine Gleichspannungsquelle zum Anlegen des Substratbias verwendet werden.

Weiters kann der Graphitanteil durch gleichzeitiges oder ebenfalls verzögert eingeschaltetes Co-Sputtern von karbidischen beispielsweise WC- und/oder Graphittargets erhöht werden. Will man die besonders günstigen Gleiteigenschaften von W- bzw. Ta oder Nb / C-Schichten nutzen, ist es vorteilhaft die Cr-Targets nach Ausbildung einer Haft- bzw. Gradientenschicht abzuschalten, bzw. herunterzuregulieren und den Prozess nur mit den entsprechenden Metall- bzw. Metallkarbidtargets zu Ende zu fahren.

Die Eigenschaften der entsprechenden DLC-Schichten sind **Tabelle 8** und

29

VersuchNr.	5	6	7
Haftung	HF 1	HF 1	HF 1
Widerstand	< 100 k $\Omega$	< 100 k $\Omega$	< 100 k $\Omega$
Reibkoeffizient	ca. 0.10	ca. 0.15	ca. 0.12

Tabelle 9 zu entnehmen:

VersuchNr.	8	9	10
Haftung	HF 1	HF 1	HF 1
Widerstand	< 1 k $\Omega$	< 1 k $\Omega$	< 100 k $\Omega$
Wasserstoffgehalt	n.g.	n.g.	> 30 atom%
Reibkoeffizient	ca. 0.08	ca. 0.07	ca. 0.13

**Merkmalssätze eines DLC-Schichtsystems**

1. Schichtsystem für den Verschleisschutz, Korrosionsschutz und zur Verbesserung der Gleiteigenschaften und dergleichen mit einer Haftschrift zur Anordnung auf einem Substrat, einer Übergangsschicht zur Anordnung auf der Haftschrift und einer Deckschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Haftschrift mindestens ein Element aus der Gruppe umfasst, die die Elemente der 4., 5. und 6. Nebengruppe und Silizium beinhaltet, die Übergangsschicht Kohlenstoff und mindestens ein Element aus der Gruppe umfasst, die die Elemente der 4., 5. und 6. Nebengruppe sowie Silizium beinhaltet, und die Deckschicht im wesentlichen diamantähnlichen Kohlenstoff umfasst, wobei das Schichtsystem eine Härte von wenigstens 15 GPa, vorzugsweise mindestens 20 GPa, und eine Haftfestigkeit von wenigstens 3 HF aufweist.
2. Schichtsystem nach Merkmalssatz 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergangsschicht eine kontinuierliche oder stufenweise in der Zusammensetzung sich ändernde einzelne oder vielschichtige Gradientenschicht ist, und zwar mit vom Substrat aus zunehmendem Kohlenstoffanteil und abnehmendem Anteil von mindestens einem Element aus der Gruppe, die die Elemente der 4., 5. und 6. Nebengruppe sowie Silizium beinhaltet.
3. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Merkmalssätze, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Deckschicht im Vergleich zur Haftschrift und zur Übergangsschicht eine grössere Dicke aufweist.
4. Schichtsysteme nach einem der vorhergehenden Merkmalssätze, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergangsschicht und/oder Deckschicht zusätzlich Wasserstoff und unvermeidbare Verunreinigungen umfasst, die unvermeidbaren Verunreinigungen Edelgase, insbesondere Argon und Xenon umfassen.
5. Schichtsystem nach Merkmalssatz 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Deckschicht ausschliesslich Kohlenstoff oder Kohlenstoff und Wasserstoff enthält.
6. Schichtsystem nach Merkmalssatz 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Deckschicht einen Wasserstoffgehalt von 5 bis 30 Atom%, vorzugsweise 10 bis 20 Atom% umfasst.
7. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Merkmalssätze, **dadurch gekennzeichnet**, dass das mindestens ein Element aus der Gruppe, die die Elemente der 4., 5. und 6. Nebengruppe umfasst, Titan und/oder Chrom ist.
8. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Merkmalssätze, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Haftschrift und die Übergangsschicht jeweils eine Dicke von 0,05  $\mu\text{m}$  bis 1,5  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise von 0,1  $\mu\text{m}$  bis 0,8  $\mu\text{m}$  aufweist.
9. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Merkmalssätze, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Deckschicht eine Dicke von 0,5  $\mu\text{m}$  bis 20  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise von 1  $\mu\text{m}$  bis 10  $\mu\text{m}$  aufweist.
10. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Merkmalssätze, **dadurch gekennzeichnet**, dass die aus diamantähnlichem Kohlenstoff bestehende Deckschicht eine feinkörnige Schichtstruktur aufweist.



11. Verfahren zur Herstellung eines Schichtsystems, insbesondere nach einem der Merkmalssätze 1 bis 10, auf einem Substrat, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Verfahren umfasst:
  - a) Einbringen des Substrates in eine Vakuumkammer und Abpumpen bis ein Vakuum mit einem Druck von weniger als  $10^{-4}$  mbar, vorzugsweise  $10^{-5}$  mbar erreicht ist.
  - b) Reinigen der Substratoberfläche
  - c) plasmagestütztes Aufdampfen der Haftschrift auf das Substrat
  - d) Aufbringen der Übergangsschicht auf die Haftschrift durch gleichzeitiges plasmagestütztes Aufdampfen der Haftschriftkomponenten und Abscheiden von Kohlenstoff aus der Gasphase
  - e) Aufbringen der diamantähnlichen Kohlenstoffschrift auf die Übergangsschicht durch plasmagestütztes Abscheiden von Kohlenstoff aus der Gasphase,  
wobei zumindest während der Verfahrensschritte c), d) und e) am Substrat eine Substratbiasspannung angelegt und zumindest während der Verfahrensschritte d) und e) das Plasma durch ein Magnetfeld stabilisiert wird.
12. Verfahren nach Merkmalssatz 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Reinigen der Substratoberfläche einen Heizschritt und/oder Ätzschritt umfasst.
13. Verfahren nach Merkmalssatz 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Heizschritt durch Strahlungsheizen, induktives Heizen und/oder durch Elektronenbeschuss erfolgt.
14. Verfahren nach Merkmalssatz 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Elektronenbeschuss durch das Zünden eines Niedervoltlichtbogens und das gleichzeitige Anlegen einer kontinuierlichen, einer AC- oder AC überlagerten Biasspannung, wie insbesondere einer gepulsten positiven Substratbiasspannung bewirkt wird.
15. Verfahren nach Merkmalssatz 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Ätzschritt durch Ionenätzen durchgeführt wird, wobei mit einem Edelgas, vorzugsweise Argon, und/oder Wasserstoff als Prozessgas eine Niedervoltlichtbogen gezündet wird und an das Substrat eine kontinuierliche negative Substratbiasspannung angelegt wird.
16. Verfahren nach Merkmalssatz 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Ätzschritt durch Ionenätzen mit einem Edelgas vorzugsweise Argon, und/oder Wasserstoff als Prozessgas durchgeführt wird, wobei eine AC- oder AC überlagerte Biasspannung, wie insbesondere eine gepulste, vorzugsweise mittelfrequente Substratbiasspannung angelegt wird.
17. Verfahren nach einem der Merkmalssätze 10 bis 16, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Aufdampfen der Haftschrift durch Plasma-CVD-Verfahren, PVD-Verfahren, insbesondere Arcverdampfung, Ionenplating-Verfahren oder kathodisches Sputtern erfolgt.
18. Verfahren nach Merkmalssatz 17, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Aufdampfen der Haftschrift durch eine zusätzliche Niedervoltlichtbogenentladung unterstützt wird und an das Substrat eine negative Substratbiasspannung angelegt wird.

19. Verfahren nach Merkmalssatz 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Aufdampfen der Haftschrift durch eine zusätzliche gepulste Substratbiasspannung, wobei eine AC- oder AC überlagerte Biasspannung, wie insbesondere eine gepulste Substratbiasspannung in einem Mittelfrequenzbereich von 1 bis 20.000 kHz, vorzugsweise 20 bis 250 kHz unterstützt wird.
20. Verfahren nach einem der Merkmalssätze 10 bis 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass für das Zünden eines Plasmas ein Edelgas oder ein Edelgas/Wasserstoff-Gemisch, vorzugsweise Argon/Wasserstoff-Gemisch in die Vakuumkammer eingebracht wird.
21. Verfahren nach einem der Merkmalssätze 10 bis 20 **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergangsschicht durch zeitgleiches Aufdampfen von mindestens einem Element aus der Gruppe, die die Elemente aus der 4., 5. und 6. Nebengruppe und Silizium enthält, nach einem Verfahren gemäss einem der Merkmalssätze 17 bis 20 und plasmagestütztes Abscheiden von Kohlenstoff aus der Gasphase gebildet wird, wobei zusätzlich als Reaktionsgas ein kohlenstoffhaltiges Gas, vorzugsweise ein Kohlenwasserstoffgas, insbesondere Acetylen verwendet wird.
22. Verfahren nach Merkmalssatz 21, **dadurch gekennzeichnet**, dass mit zunehmender Dicke der Übergangsschicht der Anteil der Kohlenstoffabscheidung schrittweise oder kontinuierlich erhöht wird.
23. Verfahren nach einem der Merkmalssätze 10 bis 22, **dadurch gekennzeichnet**, dass die die Deckschicht bildende diamantähnliche Kohlenstoffschrift durch Plasma-CVD-Abscheidung von Kohlenstoff aus der Gasphase erzeugt wird, wobei als Reaktionsgas ein kohlenstoffhaltiges Gas, vorzugsweise ein Kohlenwasserstoffgas, insbesondere Acetylen verwendet wird.
24. Verfahren nach einem der Merkmalssätze 21 oder 23, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Reaktionsgas zur Abscheidung von Kohlenstoff neben dem kohlenstoffhaltigen Gas Wasserstoff und/oder Edelgas, vorzugsweise Argon oder/und Xenon umfasst.
25. Verfahren nach Merkmalssatz 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass während des Abscheidens der Deckschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff der Anteil des kohlenstoffhaltigen Gases erhöht und/oder der Anteil des Edelgases, insbesondere Argon, gesenkt wird.
26. Verfahren nach einem der Merkmalssätze 21 bis 25, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine unipolare oder bipolare Substratbiasspannung am Substrat angelegt wird, die in einem Mittelfrequenzbereich von 1 bis 10.000 kHz, vorzugsweise 20 bis 250 kHz gepulst ist.
27. Verfahren nach Merkmalssatz 26, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Substratbiasspannung sinusförmig oder derart gepulst ist, dass lange negative und kurze positive Impulszeiten oder grosse negative und geringe positive Amplituden angelegt werden.
28. Verfahren nach einem der Merkmalssätze 10 bis 27, **dadurch gekennzeichnet**, dass während des Reinigen und/oder des Aufbringens der Haftschrift und/oder der Übergangsschicht und/oder der Deckschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff dem Substrat ein longitudinales Magnetfeld mit gleichmässigem Feldlinienverlauf überlagert wird, wobei das Magnetfeld zeitlich und/oder räumlich kontinuierlich oder schrittweise veränderbar ist.

29. Verfahren nach einem der Merkmalssätze 10 bis 28, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Aufbringen der Haftschrift und/oder Uebergangsschicht und/oder Deckschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff unter einem Druck von  $10^{-4}$  mbar bis  $10^{-2}$  mbar erfolgt
30. Vorrichtung zur Beschichtung eines oder mehrerer Substrate, insbesondere zur Durchführung des Beschichtungsverfahrens nach einem der Merkmalssätze 10 bis 29, mit einer Vakuumkammer (1) mit einem Pumpsystem (9) zur Erzeugung eines Vakuums in der Vakuumkammer (1), Substrathalterungen (3) zur Aufnahme der zu beschichtenden Substrate, mindestens einer Gasversorgungseinheit (8) zum Zudosieren von Prozessgas, mindestens einer Verdampfer-Vorrichtung (14) zur Bereitstellung von Beschichtungsmaterial zum Aufdampfen, einer Lichtbogenerzeugungseinrichtung (10, 143) zum Zünden eines Gleichspannungsniedervoltbogens, einer Vorrichtung (16) zur Erzeugung einer Substratbiasspannung und mit mindestens einer oder mehreren Magnetfelderzeugungseinrichtungen (17) zur Ausbildung eines magnetischen Fernfeldes.
31. Vorrichtung nach Merkmalssatz 30, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Magnetfelderzeugungseinrichtung (17) durch mindestens eine Helmholtzspule gebildet wird.
32. Vorrichtung nach Merkmalssatz 31, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Helmholtzspule bezüglich der erzeugbaren Magnetflussdichte steuerbar ist.
33. Vorrichtung nach einem der Merkmalssätze 30 bis 32, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Vorrichtung zur Erzeugung einer Substratbiasspannung so gestaltet ist, dass die Substratbiasspannung kontinuierlich oder schrittweise bezüglich des Vorzeichens und/oder der Grösse der angelegten Substratbiasspannung veränderbar ist und/oder bipolar oder unipolar vorzugsweise mit einer Frequenz in einem Mittelfrequenzbereich betreibbar ist.
34. Vorrichtung nach einem der Merkmalssätze 30 bis 33, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verdampfer-Vorrichtung (14) Sputtertargets, insbesondere Magnetron-Sputtertargets, Arcquellen, thermische Verdampfer und dergleichen umfasst.
35. Vorrichtung nach einem der Merkmalssätze 30 bis 34, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verdampfer-Vorrichtung (14) von der übrigen Prozesskammer (1) abtrennbar ist.
36. Vorrichtung nach einem der Merkmalssätze 30 bis 35, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Vorrichtung weiterhin eine Substratheizung in Form einer induktiven Heizung, Strahlungsheizung oder dergleichen umfasst.
37. Vorrichtung nach einem der Merkmalssätze 30 bis 36, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Lichtbogenerzeugungseinrichtung (10, 13) eine Ionenquelle (10) und eine Anode (13) sowie eine Gleichspannungsversorgung (11) umfasst, wobei die Ionenquelle (10) mit dem negativen Pol der Gleichspannungsversorgung (11) verbunden ist.
38. Vorrichtung nach Merkmalssatz 37, **dadurch gekennzeichnet**, dass der positive Pol der Gleichspannungsversorgung (11) wahlweise mit der Anode (13) oder den Substrathalterungen (3) verbindbar ist.
39. Vorrichtung nach einem der Merkmalssätze 37 oder 38, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Ionenquelle (10) ein Filamanet, vorzugsweise ein Refraktärfilament, insbe-

34/

sondere aus Wolfram, Tantal oder dergleichen umfasst, das in einer Ionisationskammer angeordnet ist, die durch eine Blende, vorzugsweise eine Refraktärbende, insbesondere aus Wolfram, Tantal oder dergleichen von der Prozesskammer (1) abtrennbar ist.

40. Vorrichtung nach einem der Merkmalssätze 30 bis 39, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Substrathalterungen (3) beweglich sind, und zwar vorzugsweise drehbar um mindestens eine oder mehrere Achsen.
41. Vorrichtung nach einem der Merkmalssätze 30 bis 40, **dadurch gekennzeichnet, dass** zusätzlich Permanentmagnete (20) zur Erzeugung eines magnetischen Nahfeldes vorgesehen sind.
42. Vorrichtung nach 41, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zusätzlichen Permanentmagnete (20) ringförmig um die Vakuumkammer (1), bevorzugt mit einer abwechselnden Polausrichtung ausgeführt sind, sowie insbesondere als Magnetronelektrodenfalle ausgebildet sind.

**Bezugszeichenliste**

1. Prozesskammer
2. zu beschichtende Teile
3. Halterungsvorrichtung
4. einfache Rotation
5. zweifache Rotation
6. Anlagenachse
7. Karussell
8. Gaseinlass
9. Pumpstand
10. Ionenquelle
11. Gleichspannungsversorgung
12. Schalter
13. Hilfsanode
14. Verdampferquelle
15. Niedervoltbogen
16. Spannungsversorgung
17. elektromagnetische Spule
18. MF-Plasma
19. Seitenwand
20. Magnetsysteme
21. Nahfelder
22. Magnetronmagnetsysteme

**Patentansprüche**

1. Schichtsystem für den Verschleisschutz, Korrosionsschutz und zur Verbesserung der Gleiteigenschaften und dergleichen mit einer Haftschrift zur Anordnung auf einem Substrat, einer Übergangsschicht zur Anordnung auf der Haftschrift, und einer DLC- oder Diamantschicht, **dadurch gekennzeichnet, dass** auf der DLC- oder Diamantschicht eine Gleitschicht angeordnet ist, deren chemische Zusammensetzung sich von der Zusammensetzung der DLC- oder Diamantschicht unterscheidet.
2. Schichtsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Anteil der  $sp^2$ -Bindungen bzw. das  $sp^2/sp^3$ -Verhältnis in der Gleitschicht grösser ist als in der DLC- oder Diamantschicht.
3. Schichtsystem nach einem der Ansprüche 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Wasserstoffgehalt der Gleitschicht gegenüber dem Wasserstoffgehalt der DLC- oder Diamantschicht erhöht und der Kohlenstoffgehalt erniedrigt ist.
4. Schichtsystem nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Gleitschicht einen Wasserstoffgehalt von 20 bis 60 Atom%, vorzugsweise 30 bis 50 Atom% umfasst.
5. Schichtsystem nach einem der Ansprüche 2 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Änderung der Bindungsverhältnisse bzw. der Zunahme des Wasserstoffs über die Dicke der Gleitschicht stufenweise oder kontinuierlich erfolgt.
6. Schichtsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Metallgehalt der Gleitschicht gegenüber dem Metallgehalt der DLC- oder Diamantschicht erhöht ist.
7. Schichtsystem nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Metallgehalt über die Gleitschicht stufenweise oder bevorzugt kontinuierlich zunimmt, der Kohlenstoffgehalt jedoch abnimmt.
8. Schichtsystem nach Anspruch 5 und 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** im Anschluss an die DLC- oder Diamantschicht zunächst eine Schicht mit hohem Metallgehalt, bevorzugt eine metallische oder karbidische Schicht, und anschliessend eine Schicht mit fallendem Metall- und wachsendem Kohlenstoffgehalt angeordnet ist.
9. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** im oberflächennahen Bereich der Gleitschicht ein Schichtbereich konstanter chemischer Zusammensetzung angeordnet ist.
10. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Reibbeiwert der Gleitschichtoberfläche kleiner  $\mu = 1.5$  bevorzugt kleiner  $\mu = 1.0$  und die Haftung des Schichtsystems besser 3 HF, insbesondere besser 2 HF ist.
11. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Übergangsschicht eine Dicke von 5 bis 60%, insbesondere zwischen 10 und 50% der Gesamtschichtdicke aufweist.
12. Schichtsysteme nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Haftschrift, die Übergangsschicht, die DLC- oder Diamantschicht

und/oder die Gleitschicht zusätzlich Wasserstoff und/oder unvermeidbare Verunreinigungen umfasst, die unvermeidbaren Verunreinigungen Edelgase, insbesondere Argon und Xenon umfassen.

13. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die DLC- oder Diamantschicht eine Dicke von von 0,5  $\mu\text{m}$  bis 20  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise von 0.7  $\mu\text{m}$  bis 10  $\mu\text{m}$  aufweist.
14. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Gleitschicht eine Dicke von 0,05  $\mu\text{m}$  bis 10  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise von 0.5  $\mu\text{m}$  bis 5  $\mu\text{m}$  aufweist.
15. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die DLC- oder Diamantschicht aus diamantähnlichem Kohlenstoff mit einer feinkörnigen Schichtstruktur oder aus nanokristallinem Diamant besteht.
16. Schichtsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Gleitschicht auf einem DLC-Schichtsystem aufgebracht ist.
17. Verfahren zur Herstellung eines Schichtsystems, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 16, auf einem Substrat, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verfahren folgende Prozessschritte umfasst:
  - a) Einbringen des Substrates in eine Vakuumkammer und Abpumpen bis ein Vakuum mit einem Druck von weniger als  $10^{-3}$  mbar, vorzugsweise  $10^{-5}$  mbar erreicht ist.
  - b) Reinigen der Substratoberfläche
  - c) plasmagestütztes Aufdampfen der Haftsicht auf das Substrat
  - d) Aufbringen der Übergangsschicht auf die Haftsicht durch gleichzeitiges plasmagestütztes Aufdampfen der Haftsichtkomponenten und Abscheiden von Kohlenstoff aus der Gasphase
  - e) Aufbringen der DLC- oder Diamantschicht auf die Übergangsschicht durch plasmagestütztes Abscheiden von Kohlenstoff aus der Gasphase,
  - f) Aufbringen der Gleitschicht auf die DLC- oder Diamantschicht durch Abscheiden von Kohlenstoff aus der Gasphase,wobei zumindest während der Verfahrensschritte c), d), e) und f) am Substrat eine Substratbiasspannung angelegt und zumindest während der Verfahrensschritte d) und e) und bevorzugt auch bei f) das Plasma durch ein Magnetfeld stabilisiert wird.
18. Verfahren nach Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest während eines der Prozessschritte b) bis f) eine sinus- bzw. anders geformte bipolare oder unipolare Substratbiasspannung am Substrat angelegt wird, die in einem Mittelfrequenzbereich von 1 bis 10.000 kHz, vorzugsweise 20 bis 250 kHz gepulst ist.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 und 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest während einem der Prozessschritte b) bis f), vorzugsweise zumindest während der Prozessschritte d) und e) ein longitudinales, die Substrate umfassendes Magnetfeld mit gleichmässigem Feldlinienverlauf angelegt wird, wobei das Magnetfeld zeitlich und/oder räumlich kontinuierlich oder schrittweise veränderbar ist.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19 **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergangsschicht und die Gleitschicht durch zeitgleiches Aufdampfen von mindestens einem Element aus der Gruppe, die die Elemente aus der 4., 5. und 6. Nebengruppe und Silizium enthält, nach einem Verfahren gemäss einem der Ansprüche 30 und 31 und plasmagestütztem Abscheiden von Kohlenstoff aus der Gasphase gebildet wird, wobei als Reaktionsgas ein kohlenstoffhaltiges Gas, vorzugsweise ein Kohlenwasserstoffgas, insbesondere Acetylen verwendet wird.
21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass zum Abscheiden der Gleitschicht zunächst eine metallhaltige Schicht, vorzugsweise eine metallische oder karbidische Schicht, auf der DLC- oder Diamantschicht aufgebracht wird und mit zunehmender Dicke der Gleitschicht in Richtung der Oberfläche der Anteil der Kohlenstoffabscheidung schrittweise oder kontinuierlich erhöht wird.
22. Verfahren nach Ansprüchen 17 bis 21, **dadurch gekennzeichnet**, dass mit zunehmender Dicke der Gleitschicht in Richtung der Oberfläche der Anteil der Kohlenstoffabscheidung schrittweise oder kontinuierlich herabgesetzt und der Anteil der Metall- oder der Wasserstoffabscheidung erhöht wird.
23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22, **dadurch gekennzeichnet**, dass die DLC- oder Diamantschicht durch Plasma-CVD-Abscheidung von Kohlenstoff aus der Gasphase erzeugt wird, wobei als Reaktionsgas ein kohlenstoffhaltiges Gas, vorzugsweise ein Kohlenwasserstoffgas, insbesondere Acetylen verwendet wird.
24. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 23, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Prozessschritte b) bis f) unter einem Druck von  $10^{-4}$  mbar bis  $10^{-2}$  mbar durchgeführt werden.
25. Vorrichtung zur Beschichtung eines oder mehrerer Substrate, insbesondere zur Durchführung des Beschichtungsverfahrens nach einem der Merkmalssätze 17 bis 24, mit einer Vakuumkammer (1) mit einem Pumpsystem (9) zur Erzeugung eines Vakuums in der Vakuumkammer (1), Substrathalterungen (3) zur Aufnahme der zu beschichtenden Substrate, mindestens einer Gasversorgungseinheit (8) zum Zudosieren von Prozessgas, mindestens einer Verdampfer-Vorrichtung (14) zur Bereitstellung von Beschichtungsmaterial zum Aufdampfen, einer Lichtbogenerzeugungseinrichtung (10, 143) zum Zünden eines Gleichspannungsniedervoltbogens, einer Vorrichtung (16) zur Erzeugung einer Substratbiasspannung und mit mindestens einer oder mehreren Magnetfelderzeugungseinrichtungen (17) zur Ausbildung eines magnetischen Fernfeldes.
26. Vorrichtung nach Anspruch 25, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Magnetfelderzeugungseinrichtung zur Ausbildung eines magnetischen Fernfelds zumindest zwei elektromagnetische Spulen umfasst, die jeweils eine von zwei gegenüberliegend angeordneten Magnetronvorrichtungen seitlich umschliessen, wobei die Polungen der gegenüberliegenden Magnetronmagnetsysteme so ausgerichtet sind, dass dem Nordpol des einen Systems ein Südpol des anderen Systems gegenüber steht und gleichzeitig die jeweils zugeordneten Spulen so an eine Stromquelle angeschlossen sind, dass sich die Felder der Magnetspulen zu einem geschlossenen Magnetfeld ergänzen und die Polung der Aussenpole der Magnetronmagnetsysteme und der Magnetspulen gleichsinnig ist.



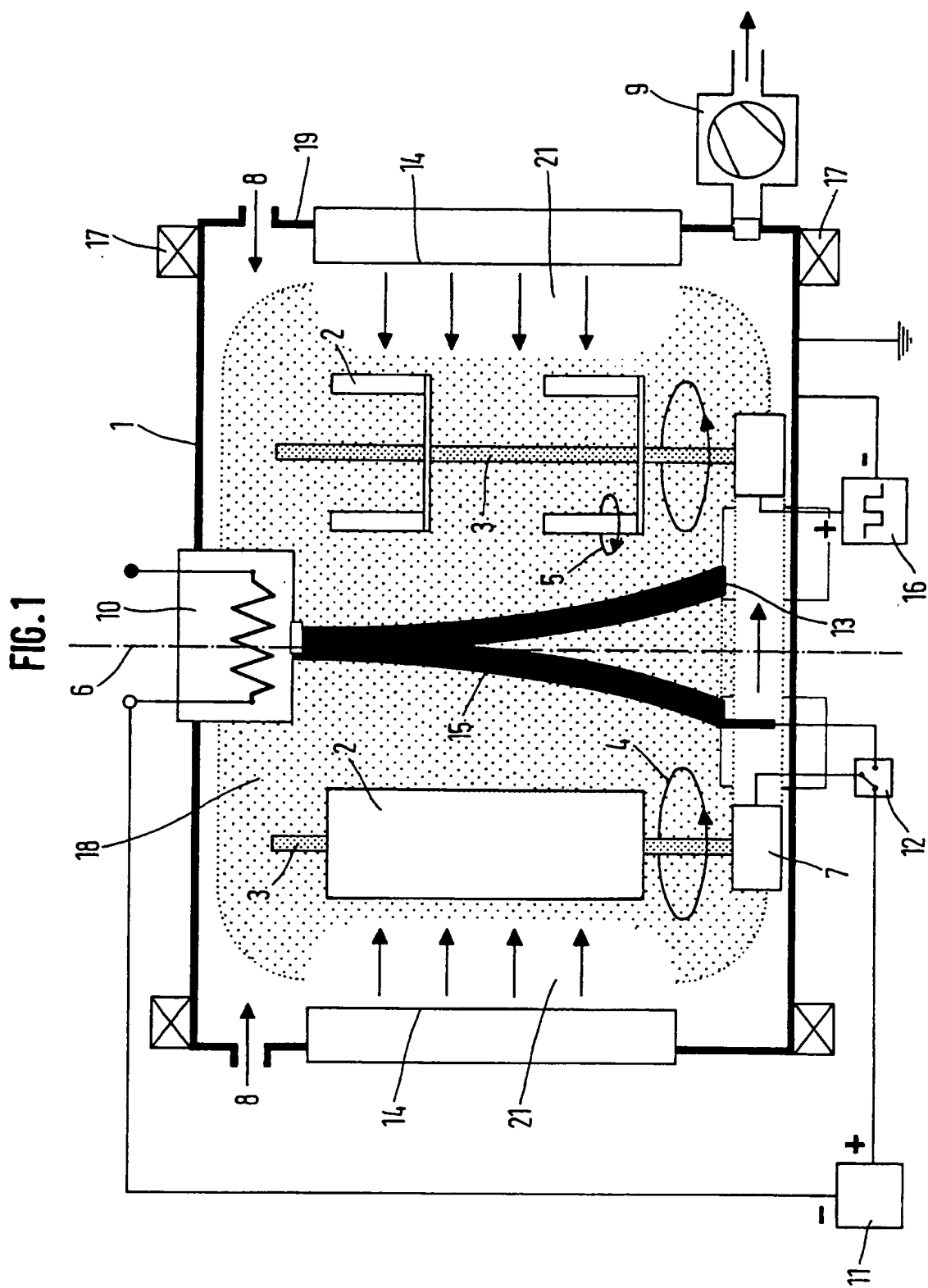
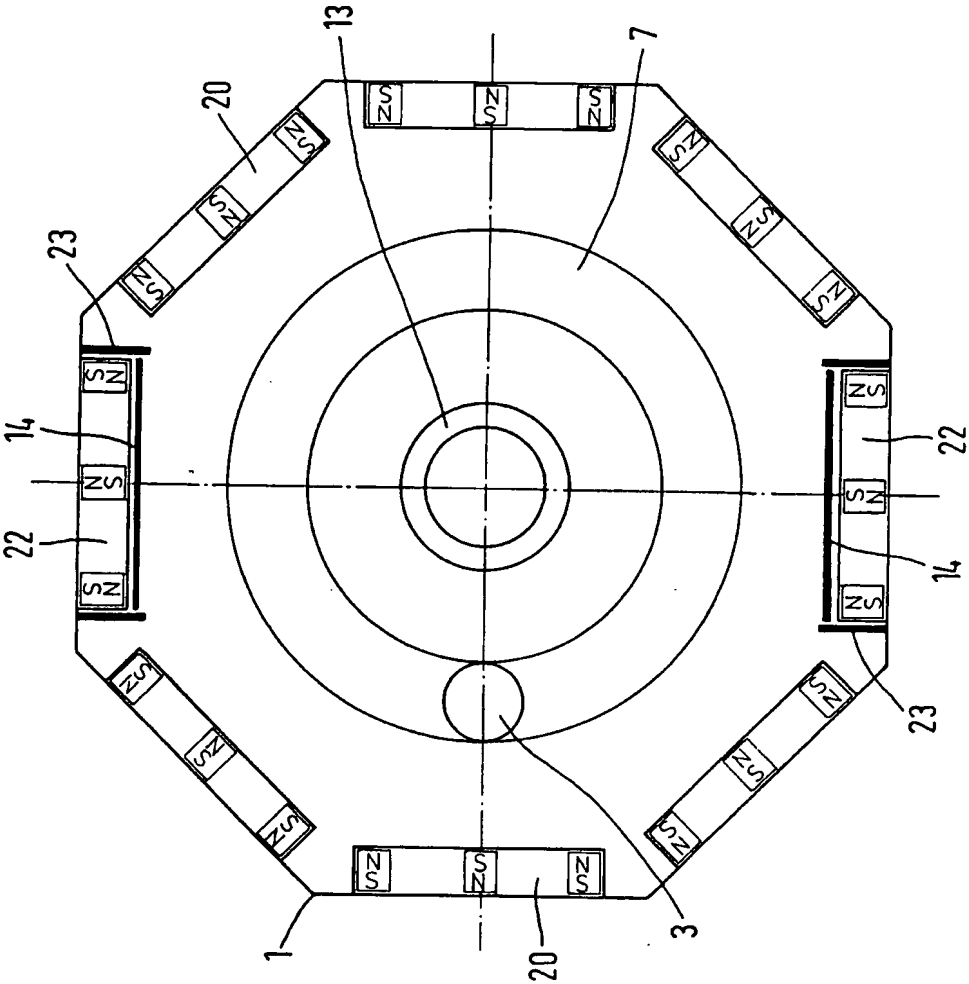


FIG. 2



3/11

FIG. 3

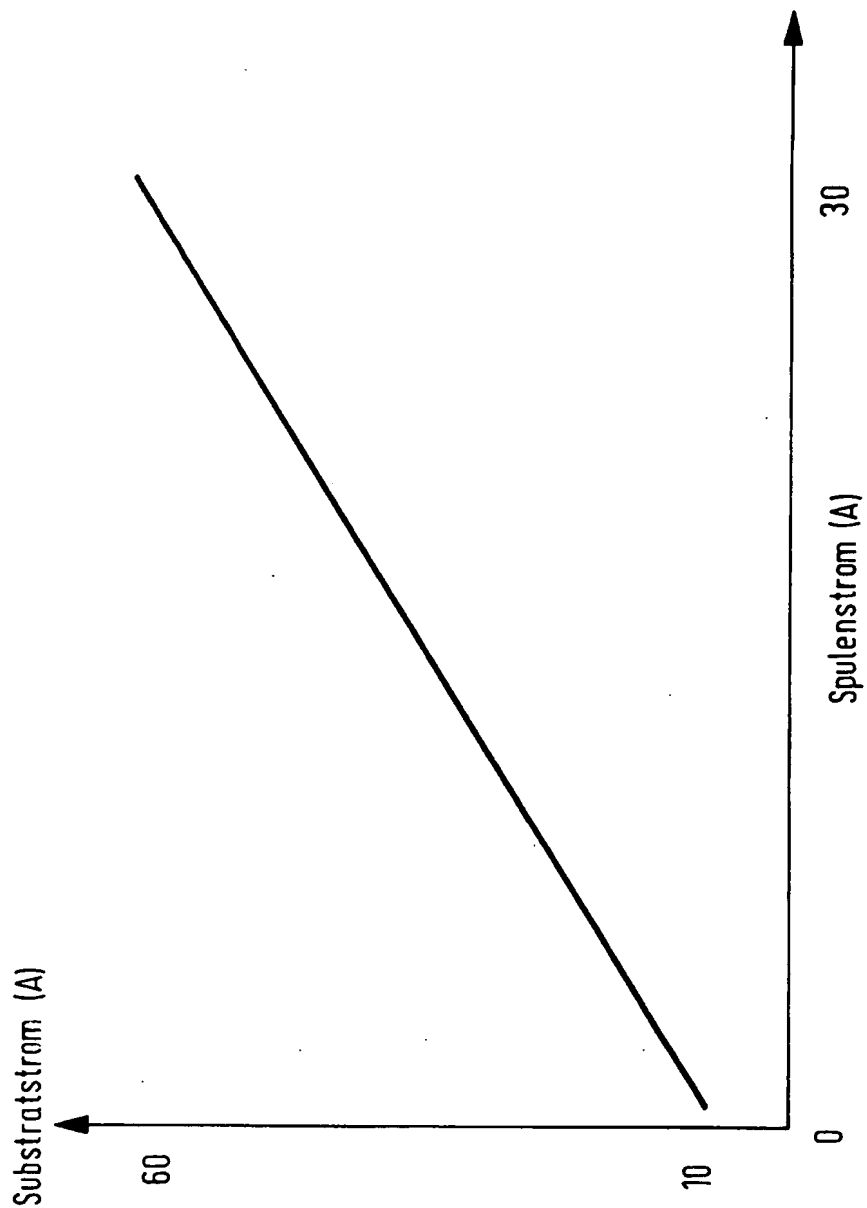


FIG. 4

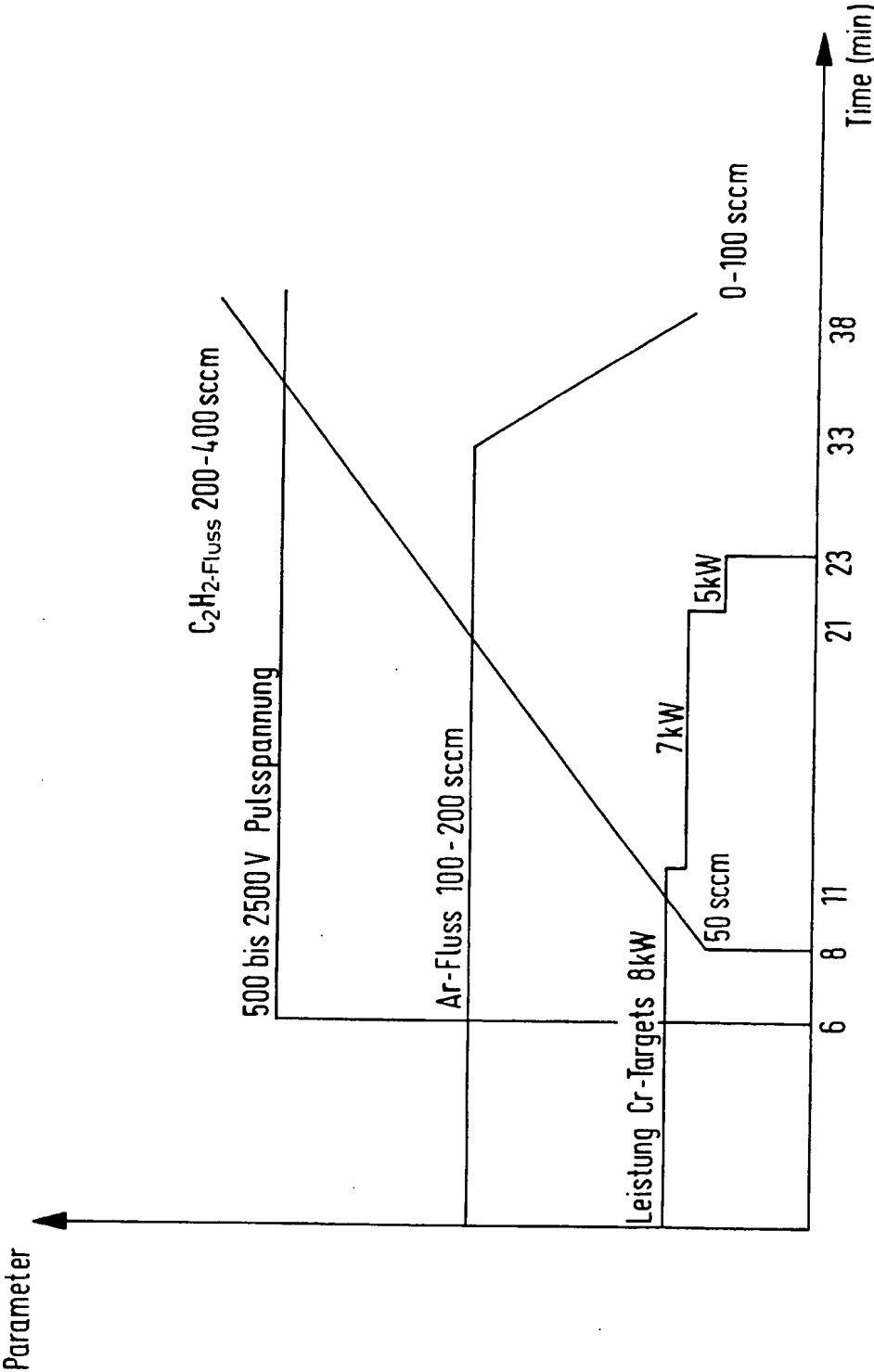
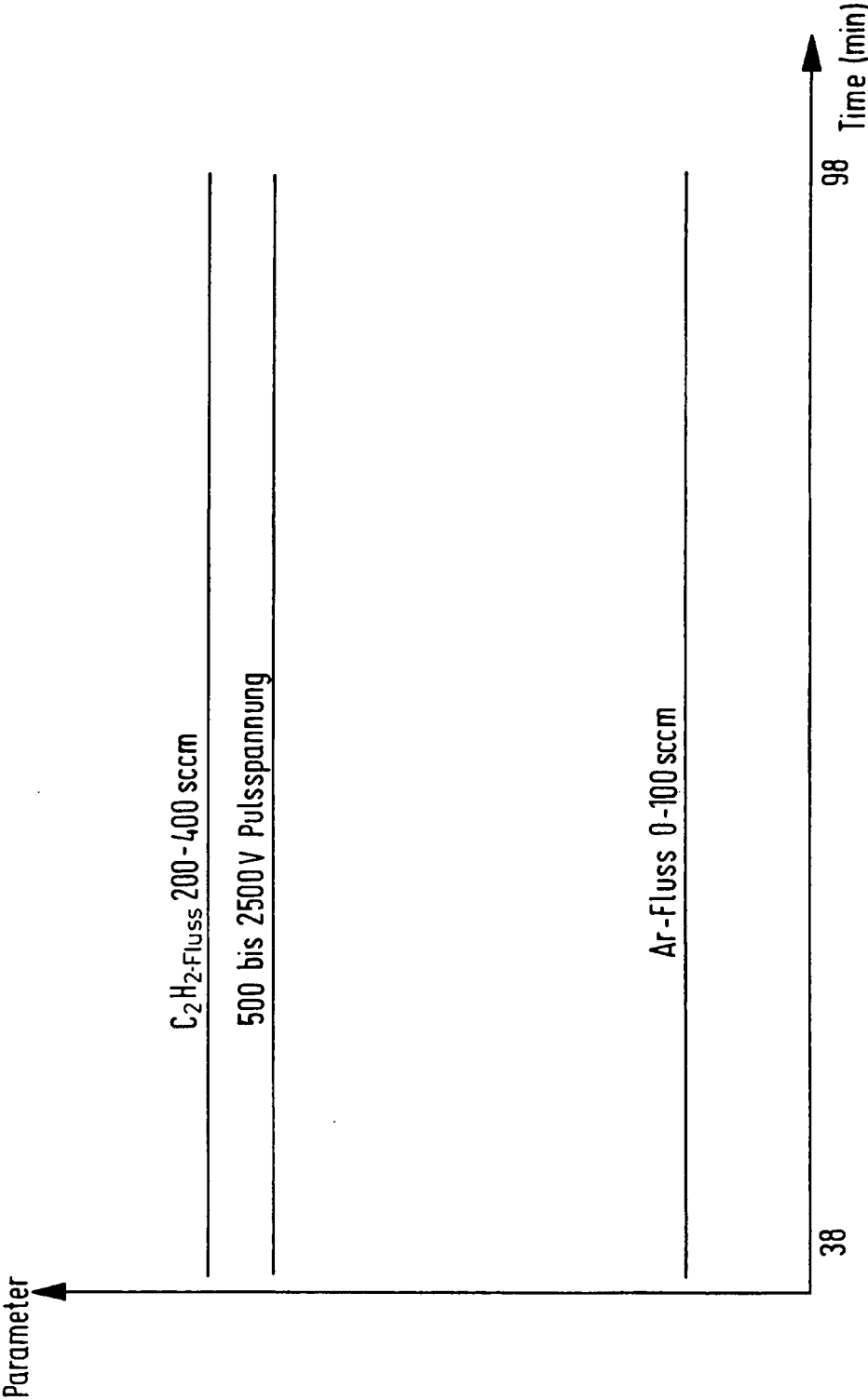
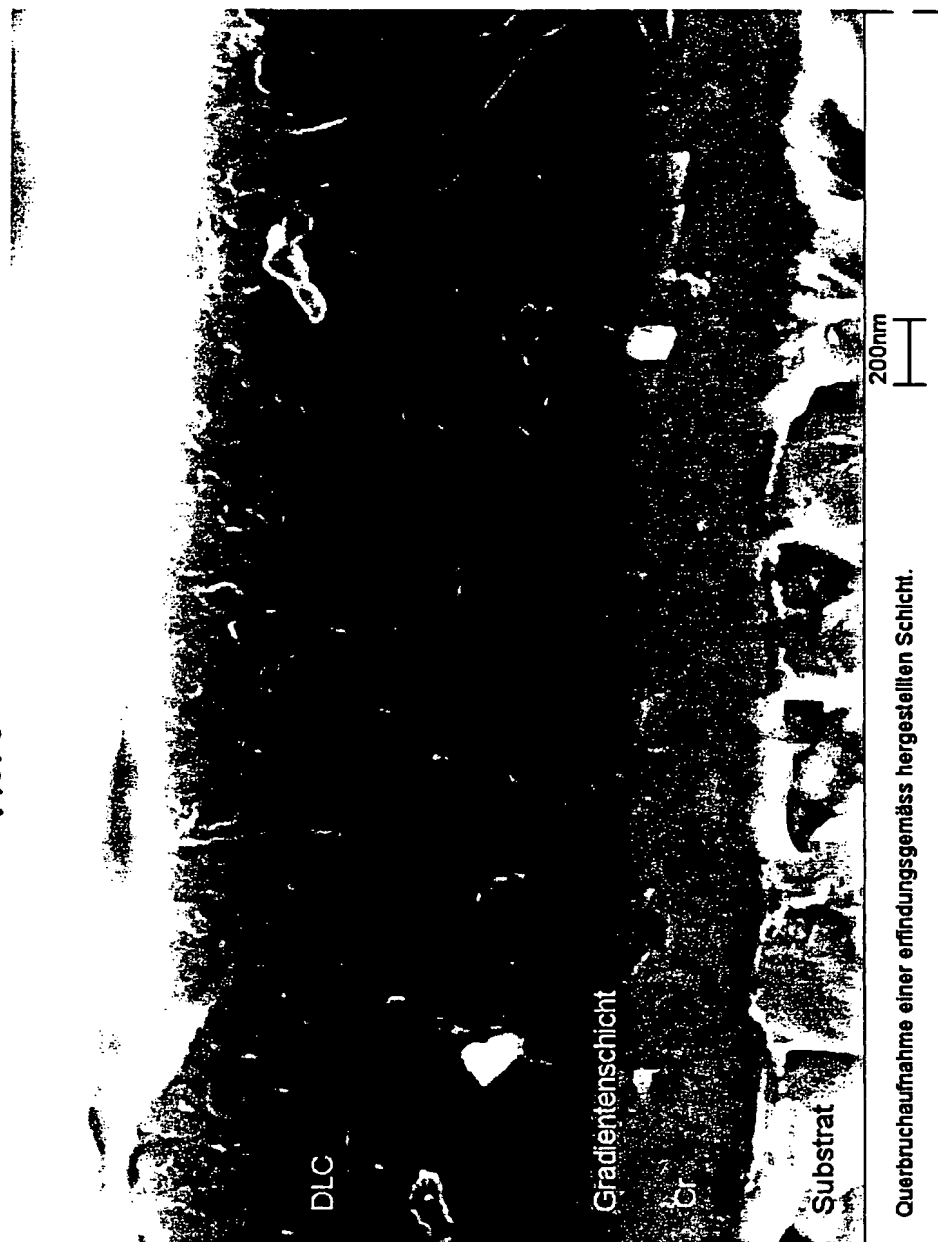


FIG. 5



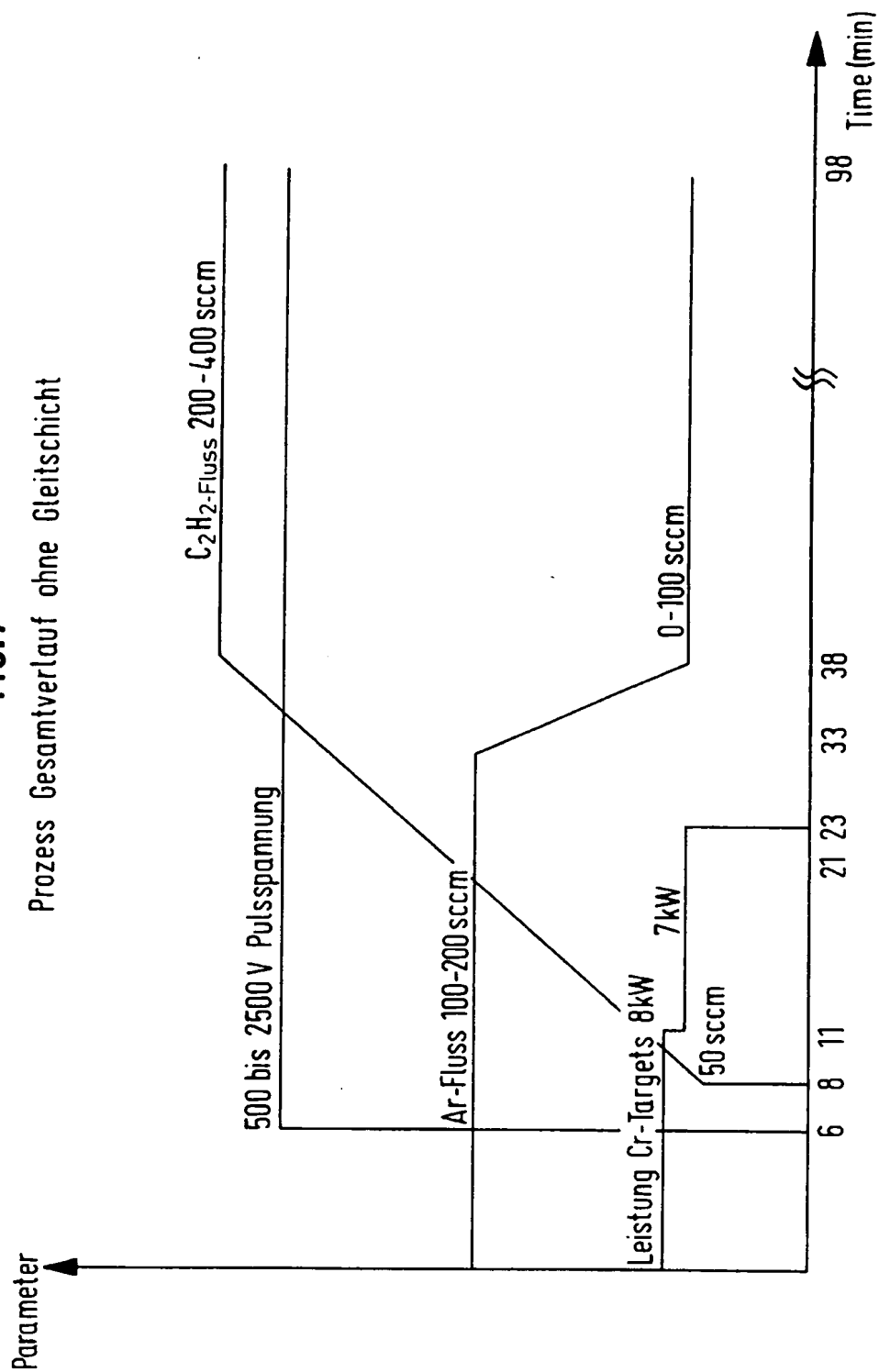
6/11

FIG. 6



7/11

**FIG. 7**  
Prozess Gesamtverlauf ohne Gleitschicht



8/11

FIG. 8

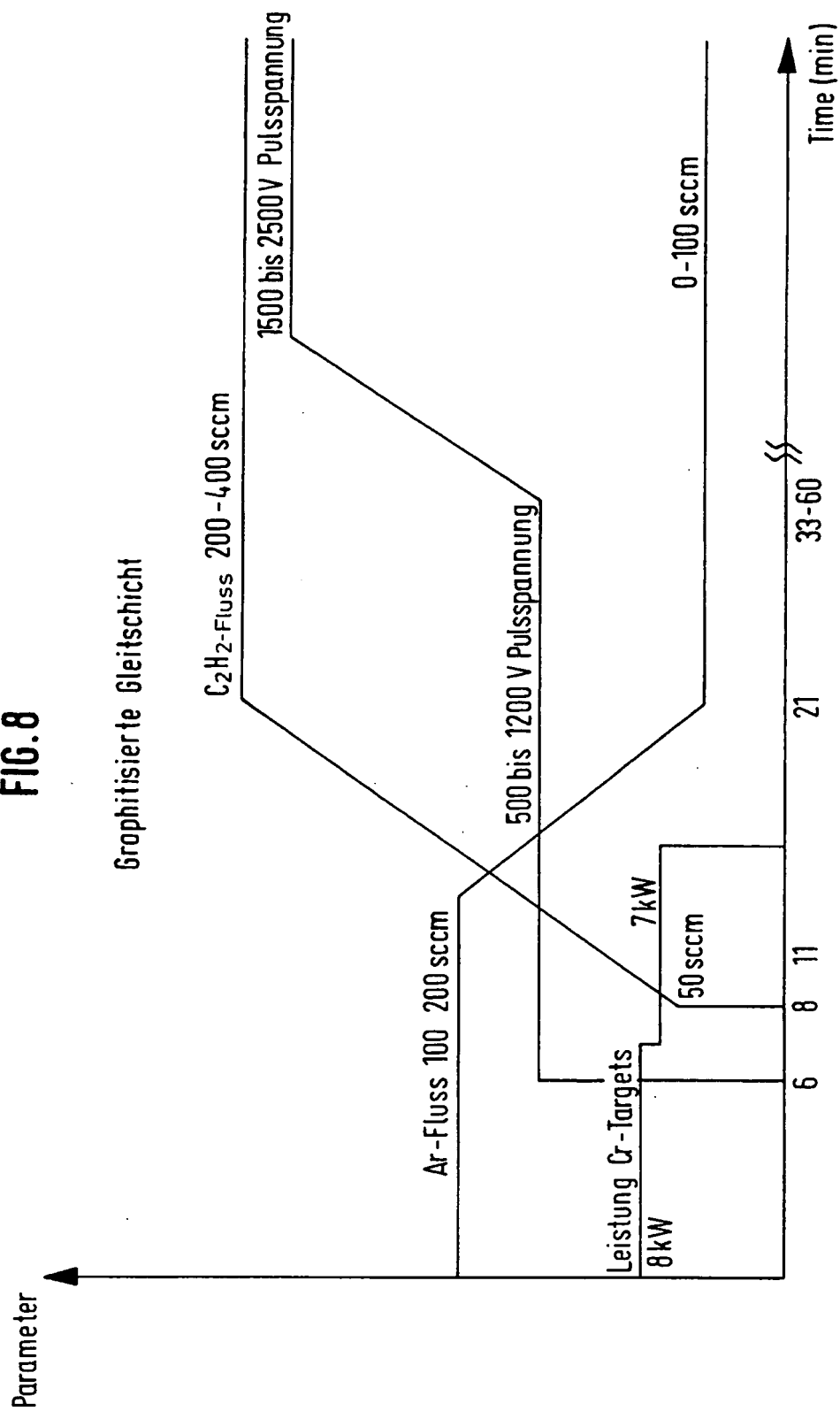
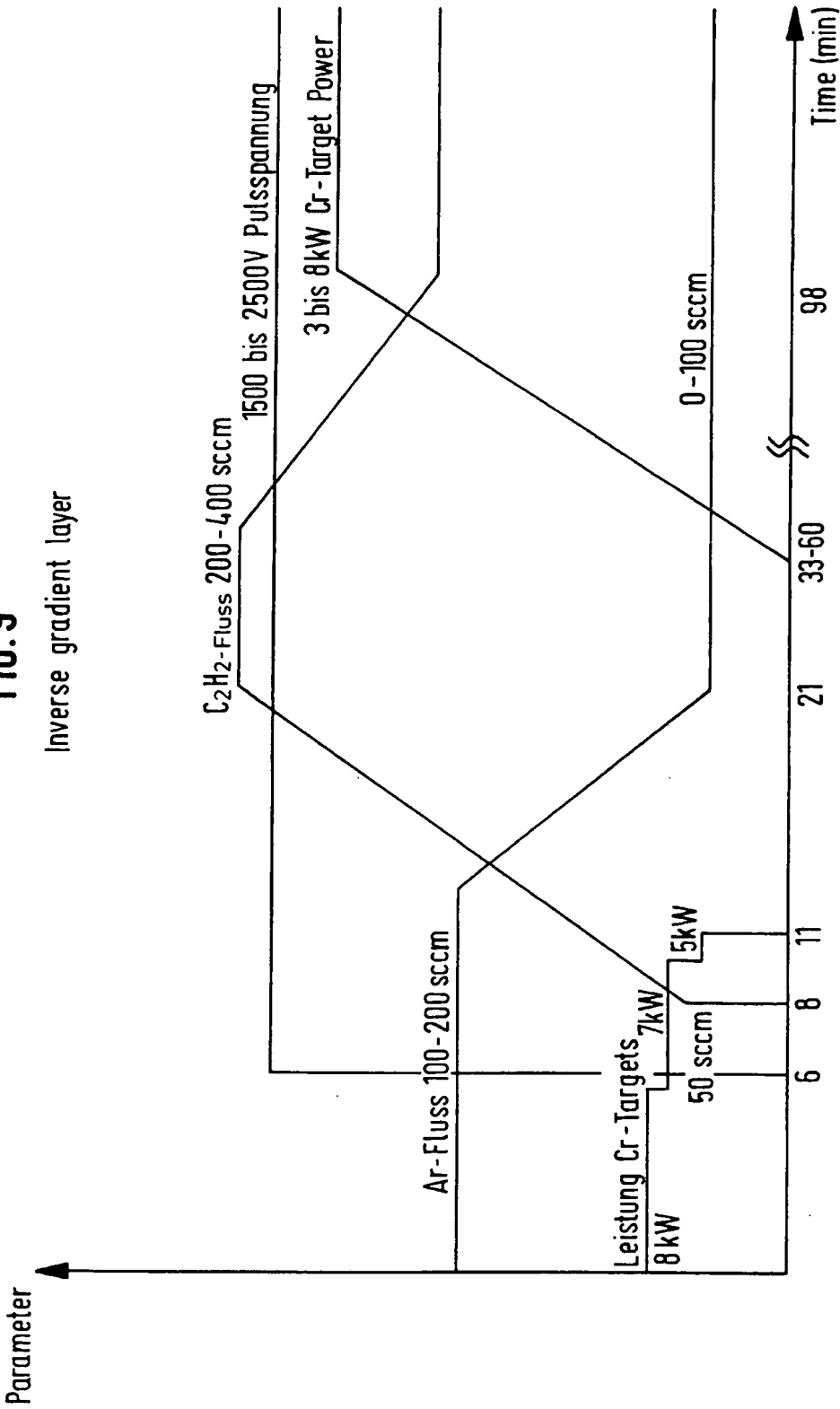




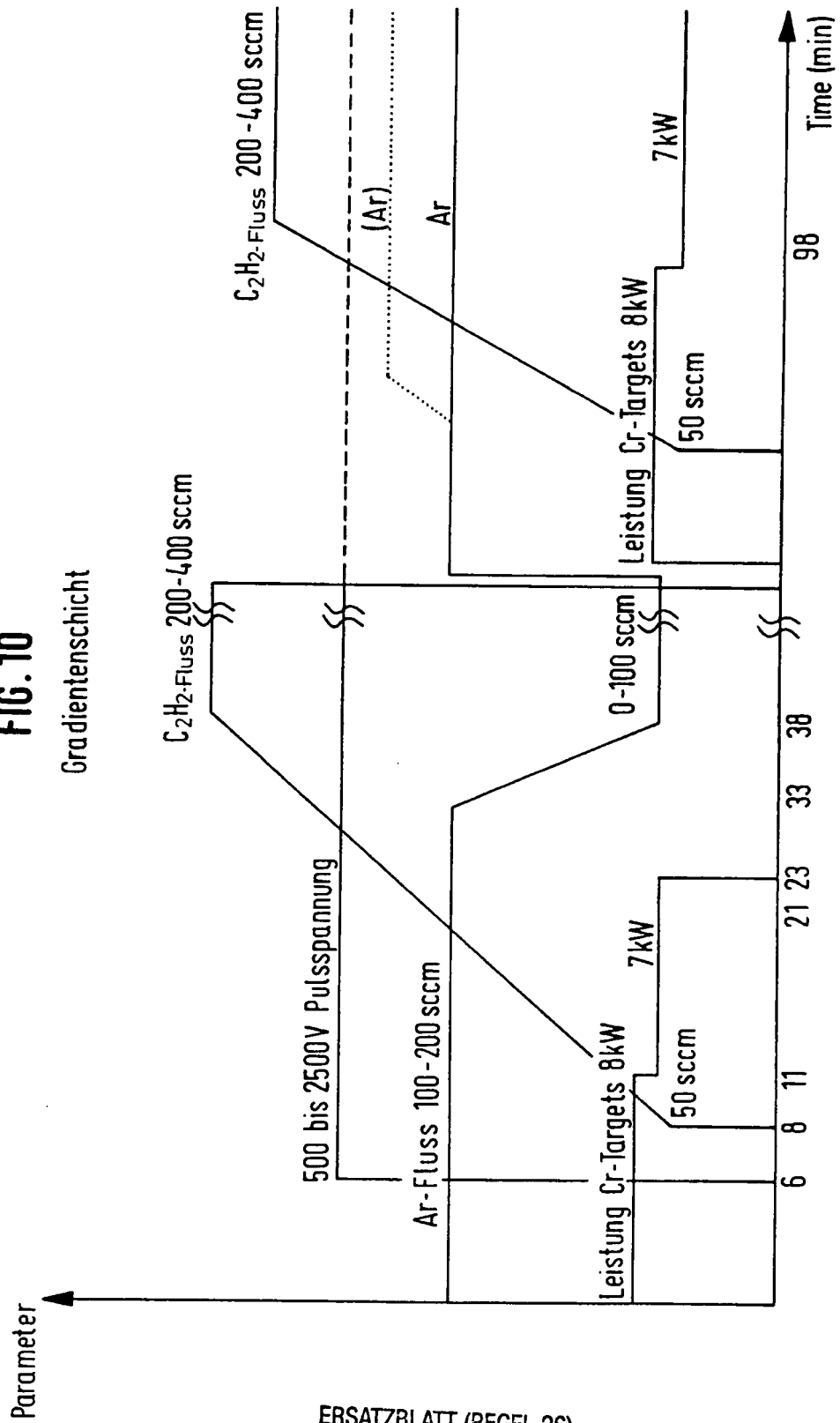
FIG. 9

Inverse gradient layer



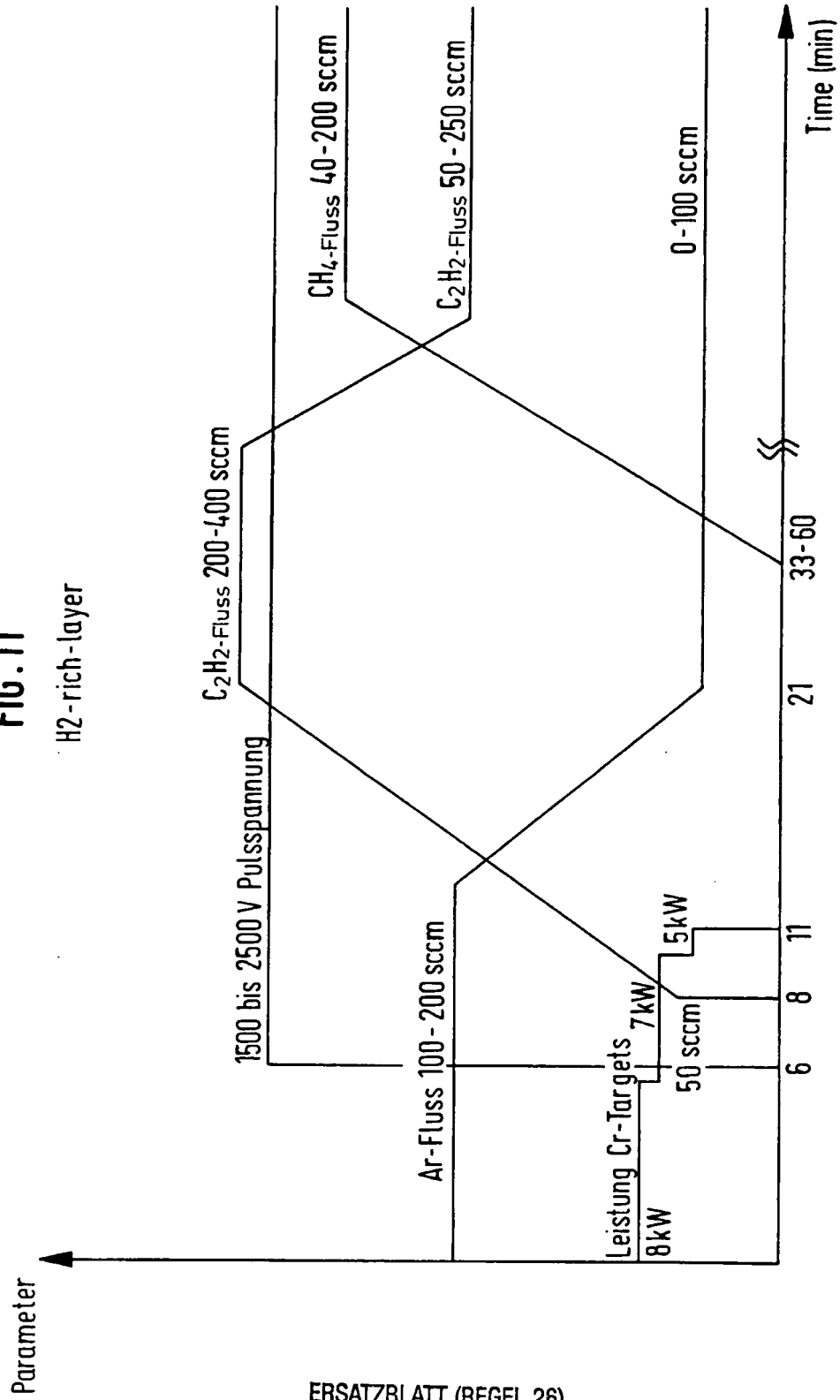
10/11

FIG. 10



11/11

FIG. 11

H<sub>2</sub>-rich-layer

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 00/13299

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C23C16/26 C23C16/02 H01J37/32 C23C14/35

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C23C H01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, IBM-TDB

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 768 046 A (KIM KEUN-MO ET AL) 16 June 1998 (1998-06-16) column 3, line 64 -column 4, line 11 ---	1,2
X	EP 0 579 983 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 26 January 1994 (1994-01-26) page 7, line 4 -page 8, line 16 ---	1,6
X	US 5 709 784 A (BRAENDLE HANS ET AL) 20 January 1998 (1998-01-20) column 8, line 4 - line 65 ---	25
A	---	26
A	US 5 750 210 A (SCHMIDT PAUL HERMAN ET AL) 12 May 1998 (1998-05-12) column 9, line 11 - line 49; table 1 ---	1-24
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

\*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

\*E\* earlier document but published on or after the international filing date

\*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

\*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

\*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 April 2001

Date of mailing of the international search report

07/05/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Ekhuult, H

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 00/13299

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 229 936 A (KARL MARX STADT TECH HOCHSCHUL) 29 July 1987 (1987-07-29) page 5, line 15 - line 35 ---	6-8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 040 (C-474), 5 February 1988 (1988-02-05) & JP 62 188776 A (SUMITOMO ELECTRIC IND LTD), 18 August 1987 (1987-08-18) abstract ---	26
P, X	US 6 066 399 A (DOMOTO YOICHI ET AL) 23 May 2000 (2000-05-23) column 3, line 19 - line 32 column 4, line 14 - line 37; figures 5,6,9 & PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 14, 31 December 1998 (1998-12-31) & JP 11 100294 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 13 April 1999 (1999-04-13) abstract & PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 14, 31 December 1998 (1998-12-31) & JP 10 259482 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 29 September 1998 (1998-09-29) abstract & PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 14, 31 December 1998 (1998-12-31) & JP 10 259481 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 29 September 1998 (1998-09-29) abstract -----	1-5,12, 15,16

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/13299

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5768046	A	16-06-1998	KR 136632 B	15-05-1998
			JP 2918816 B	12-07-1999
			JP 8063840 A	08-03-1996
			US 5695565 A	09-12-1997
			US 5938838 A	17-08-1999
EP 0579983	A	26-01-1994	JP 6212429 A	02-08-1994
US 5709784	A	20-01-1998	WO 9734315 A	18-09-1997
			DE 29615190 U	28-11-1996
			EP 0886880 A	30-12-1998
			JP 2000506225 T	23-05-2000
US 5750210	A	12-05-1998	US 5266409 A	30-11-1993
			CA 2013282 A	28-10-1990
			EP 0395198 A	31-10-1990
			JP 3131509 A	05-06-1991
EP 0229936	A	29-07-1987	DD 243514 A	04-03-1987
			DE 3674907 D	15-11-1990
			JP 63026350 A	03-02-1988
			US 4731302 A	15-03-1988
JP 62188776	A	18-08-1987	NONE	
US 6066399	A	23-05-2000	JP 10259482 A	29-09-1998
			JP 10259481 A	29-09-1998
			JP 11100294 A	13-04-1999

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/13299

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C23C16/26 C23C16/02 H01J37/32 C23C14/35

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C23C H01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, IBM-TDB

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 768 046 A (KIM KEUN-MO ET AL) 16. Juni 1998 (1998-06-16) Spalte 3, Zeile 64 - Spalte 4, Zeile 11 ---	1,2
X	EP 0 579 983 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 26. Januar 1994 (1994-01-26) Seite 7, Zeile 4 - Seite 8, Zeile 16 ---	1,6
X	US 5 709 784 A (BRAENDLE HANS ET AL) 20. Januar 1998 (1998-01-20) Spalte 8, Zeile 4 - Zeile 65 ---	25
A	---	26
A	US 5 750 210 A (SCHMIDT PAUL HERMAN ET AL) 12. Mai 1998 (1998-05-12) Spalte 9, Zeile 11 - Zeile 49; Tabelle 1 ---	1-24
	--- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

26. April 2001

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

07/05/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Ekhult, H

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/13299

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 229 936 A (KARL MARX STADT TECH HOCHSCHUL) 29. Juli 1987 (1987-07-29) Seite 5, Zeile 15 - Zeile 35 ---	6-8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 040 (C-474), 5. Februar 1988 (1988-02-05) & JP 62 188776 A (SUMITOMO ELECTRIC IND LTD), 18. August 1987 (1987-08-18) Zusammenfassung ---	26
P,X	US 6 066 399 A (DOMOTO YOICHI ET AL) 23. Mai 2000 (2000-05-23) Spalte 3, Zeile 19 - Zeile 32 Spalte 4, Zeile 14 - Zeile 37; Abbildungen 5,6,9 & PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 14, 31. Dezember 1998 (1998-12-31) & JP 11 100294 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 13. April 1999 (1999-04-13) Zusammenfassung & PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 14, 31. Dezember 1998 (1998-12-31) & JP 10 259482 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 29. September 1998 (1998-09-29) Zusammenfassung & PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 14, 31. Dezember 1998 (1998-12-31) & JP 10 259481 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 29. September 1998 (1998-09-29) Zusammenfassung -----	1-5,12, 15,16



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/13299

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5768046 A	16-06-1998	KR 136632 B	15-05-1998
		JP 2918816 B	12-07-1999
		JP 8063840 A	08-03-1996
		US 5695565 A	09-12-1997
		US 5938838 A	17-08-1999
EP 0579983 A	26-01-1994	JP 6212429 A	02-08-1994
US 5709784 A	20-01-1998	WO 9734315 A	18-09-1997
		DE 29615190 U	28-11-1996
		EP 0886880 A	30-12-1998
		JP 2000506225 T	23-05-2000
US 5750210 A	12-05-1998	US 5266409 A	30-11-1993
		CA 2013282 A	28-10-1990
		EP 0395198 A	31-10-1990
		JP 3131509 A	05-06-1991
EP 0229936 A	29-07-1987	DD 243514 A	04-03-1987
		DE 3674907 D	15-11-1990
		JP 63026350 A	03-02-1988
		US 4731302 A	15-03-1988
JP 62188776 A	18-08-1987	KEINE	
US 6066399 A	23-05-2000	JP 10259482 A	29-09-1998
		JP 10259481 A	29-09-1998
		JP 11100294 A	13-04-1999